DIALOG(R)File 347:JAPIO (c) 2006 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

08418377 **Image available**

ORGANIC ELEMENT, ORGANIC EL ELEMENT, ORGANIC SOLAR CELL, ORGANIC FET STRUCTURE AND MANUFACTURING METHOD OF ORGANIC ELEMENT

PUB. NO.:

2005-166637 [JP 2005166637 A]

PUBLISHED:

June 23, 2005 (20050623)

INVENTOR(s):

MATSUMOTO TOSHIO

YOKOI HIROSHI

NAKADA SOJI

KAWAMURA NORIFUMI

KIDO JUNJI

APPLICANT(s):

KIDO JUNJI

INTERNATIONAL MANUFACTURING & ENGINEERING

SERVICES CO LTD

APPL. NO.:

2004-294120 [JP 2004294120]

FILED:

October 06, 2004 (20041006)

PRIORITY:

2003-380338 [JP 2003380338], JP (Japan), November 10, 2003

(20031110)

INTL CLASS:

H05B-033/22; C09K-011/06; H01L-029/80; H01L-031/04;

H01L-051/00; H05B-033/10; H05B-033/14

ABSTRACT

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an organic element capable of overcoming drawbacks of a conventional organic element.

SOLUTION: This organic device has a hole current-electron current conversion layer composed by laminating an electron transportation section and a hole transportation section. The electron transportation section includes a charge transfer complex formed upon an oxidation-reduction reaction between a reduced low work function metal and an electron-accepting organic substance, the reduced metal being produced upon an in-situ thermal reduction reaction caused upon contact, through lamination or mixing by co-deposition, of an organic metal complex compound containing at least one metal

ion selected from ions of low work function metals having a work function of not more than 4.0 eV, and a thermally reducible metal capable of reducing a metal ion contained in the organic metal complex compound in vacuum to the corresponding metal state, and the electron transportation section having the electron-accepting organic substance in the state of radical anions. The hole transportation section includes an organic compound having an ionization potential less than 5.7 eV and an electron-donating property and an inorganic or organic substance capable of forming a charge transfer complex upon its oxidation-reduction reaction with the organic compound, the organic compound and the inorganic or organic substance being contacted through lamination or mixing, and the electron-donating organic compound is in the state of radical cations.

COPYRIGHT: (C)2005, JPO&NCIPI

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

JP 2005-166637 A 2005.6.23 (11)特許出願公開番号

特開2005-166637

(P2005-166637A) (43)公開日 平成17年6月23日(2005.6.23)

(51) Int. Cl. 7		FI			テ	ーマコード	(参考)
H 0 5 B	33/22	H05B	33/22	В	3	K007	
C 0 9 K	11/06	H 0 5 B	33/22	D	5	F 0 5 1	
H 0 1 L	29/80	C 0 9 K	11/06	6 6 0	5	F 1 0 2	
H 0 1 L	31/04	C 0 9 K	11/06	6 9 0			
H 0 1 L	51/00	H 0 5 B	33/10				
		審査請求	未請求	請求項の数34	OL	(全56頁)	最終頁に続く

(21)出願番号 特願2004-294120(P2004-294120) (22)出願日 平成16年10月6日(2004.10.6) (31)優先権主張番号 特願2003-380338(P2003-380338) (32)優先日 平成15年11月10日(2003.11.10)

(33)優先権主張国 日本国(JP)

(71)出願人 501231510

城戸 淳二

山形県米沢市林泉寺3-12-16

(71)出願人 593191350

株式会社アイメス

神奈川県藤沢市桐原町3番地

(74)代理人 100083286

弁理士 三浦 邦夫

(74)代理人 100120204

弁理士 平山 巌

(72)発明者 松本 敏男

神奈川県藤沢市桐原町3番地 株式会社ア

イメス内

最終頁に続く

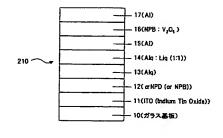
(54)【発明の名称】有機素子、有機EL素子、有機太陽電池、及び、有機FET構造、並びに、有機素子の製造方法

(57)【要約】 (修正有)

【課題】従来型有機素子の持つ欠点を克服した有機素子 の提供。

【解決手段】 仕事関数が4.0 e V以下の低仕事関数 金属のイオンのうち少なくとも1種を含む有機金属錯体 化合物と、有機金属錯体化合物中に含まれる金属イオン を真空中で金属状態に還元しうる熱還元性金属と、を積 層もしくは共蒸着による混合により接触させて引き起こされたその場熱還元反応によって還元された低仕事関数 金属と電子受容性有機物とが酸化還元反応によって収まり、電子受容性有機物がラジカルシシャルが5.7 e Vより小さく電子供与性を有する有機 1 である 1 である

【選択図】 図1



【特許請求の範囲】

【請求項1】

仕 事 関 数 が 4 . 0 e V 以 下 の 低 仕 事 関 数 金 属 の イ オ ン の う ち 少 な く と も 1 種 を 含 む 有 機 金 属錯体化合物と、前記有機金属錯体化合物中に含まれる金属イオンを真空中で金属状態に 還 元 し う る 熱 還 元 性 金 属 と 、 を 積 層 も し く は 共 蒸 着 に よ る 混 合 に よ り 接 触 さ せ て 引 き 起 こ されたその場熱還元反応によって還元された低仕事関数金属と電子受容性有機物とが酸化 還元反応によって電荷移動錯体を形成して、前記電子受容性有機物がラジカルアニオン状 態にある電子輸送部、及び

イオン化ポテンシャルが5.7eVより小さく電子供与性を有する有機化合物と、前記 有機化合物と酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成しうる無機物質又は有機物質と、 が積層または混合されて接触しており、前記電子供与性を有する有機物がラジカルカチオ ン状態にあるホール輸送部、

が 積 層 さ れ て な る ホ ー ル 電 流 ー 電 子 電 流 変 換 層 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 有 機 素 子 。

【請求項2】

仕事関数が4.0eV以下の低仕事関数金属のイオンのうち、少なくとも1種を含む無機 化合物と、前記無機化合物中に含まれる金属イオンを真空中で金属状態に還元しうる熱還 元性 金属と、 を 積 層 も しく は 共 蒸 着 に よ る 混 合 に よ り 接 触 さ せ て 引 き 起 こ さ れ た そ の 場 熱 還 元 反 応 に よ っ て 還 元 さ れ た 低 仕 事 関 数 金 属 と 電 子 受 容 性 有 機 物 と が 、 酸 化 還 元 反 応 に よ っ て 電 荷 移 動 錯 体 を 形 成 し て 、 前 記 電 子 受 容 性 有 機 物 が ラ ジ カ ル ア ニ オ ン 状 態 に あ る 電 子 輸送部(熱還元反応生成部)、及び

イオン化ポテンシャルが 5.7 e V より小さく電子供与性を有する有機化合物と、前記 有機化合物と酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成しうる無機物質又は有機物質とが 、 積 層 ま た は 混 合 さ れ て 接 触 し て お り 、 前 記 電 子 供 与 性 を 有 す る 有 機 物 が ラ ジ カ ル カ チ オ ン 状 態 に あ る ホ ー ル 輸 送 部 、 が 積 層 さ れ て な る ホ ー ル 電 流 - 電 子 電 流 変 換 層 を 含 む こ と を 特徴とする有機素子。

【請求項3】

電 子 輪 送 部 と 、 ホ ー ル 輸 送 部 と 、 を 積 層 し て な る ホ ー ル 電 流 - 電 子 電 流 変 換 層 を 含 み 、 前記電子輸送部は、

仕事関数が4.0eV以下の低仕事関数金属のイオンのうち少なくとも1種を含む有機金 属錯体化合物と、

前記有機金属錯体化合物に対して積層もしくは共蒸着による混合により接触し、前記有機 金 属 錯 体 中 に 含 ま れ る 金 属 イ オ ン を 真 空 中 で 金 属 状 態 に 還 元 し う る 熱 還 元 性 金 属 と 、 を 有

前 記 接 触 に よ り 引 き 起 こ さ れ た そ の 場 熱 還 元 反 応 に よ っ て 還 元 さ れ た 低 仕 事 関 数 金 属 と 電 子受容性有機物とが酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成して、前記電子受容性有機 物がラジカルアニオン状態にあり、

前 記 ホール 輸 送 層 は 、 イ オ ン 化 ポ テ ン シ ャ ル が 5. 7 e V よ り 小 さ く 電 子 供 与 性 を 有 す る 有機化合物と、前記有機化合物に対して積層または混合されて接触し、前記有機化合物と 酸 化 還 元 反 応 に よ っ て 電 荷 移 動 錯 体 を 形 成 し う る 無 機 物 質 又 は 有 機 物 質 と 、 を 有 し 、

前記電子供与性を有する有機物がラジカルカチオン状態にあることを特徴とする有機素子 40

【請求項4】

電 子 輪 送 部 と 、 ホ ー ル 輪 送 部 と 、 を 積 層 し て な る ホ ー ル 電 流 - 電 子 電 流 変 換 層 を 含 み 、 前記電子輸送部は、

仕事関数が4.0eV以下の低仕事関数金属のイオンのうち少なくとも1種を含む無機化 合物と、

前 記 無 機 化 合 物 に 対 し て 積 層 も し く は 共 蒸 着 に よ る 混 合 に よ り 接 触 し 、 前 記 有 機 金 属 錯 体 中に含まれる金属イオンを真空中で金属状態に還元しうる熱還元性金属と、を有し、

前記接触により引き起こされたその場熱還元反応によって還元された低仕事関数金属と電 子受容性有機物とが酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成して、前記電子受容性有機 50

20

30

物がラジカルアニオン状態にあり、

前記ホール輸送層は、

イオン化ポテンシャルが5.7eVより小さく電子供与性を有する有機化合物と、

前記有機化合物に対して積層または混合されて接触し、前記有機化合物と酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成しうる無機物質又は有機物質と、を有し、

前記電子供与性を有する有機物がラジカルカチオン状態にあることを特徴とする有機素子

【請求項5】

請求項1または請求項3に記載の有機素子において、前記有機金属錯体化合物と前記電子 受容性有機物が積層、または混合されて接触している有機素子。

【請求項6】

請求項2または請求項4に記載の有機素子において、前記無機化合物と前記電子受容性有機物が積層、または混合されて接触している有機素子。

【請求項7】

請求項1または請求項3に記載の有機素子において、前記有機金属錯体化合物中で金属イオンに配位もしくは結合している有機分子部分が前記電子受容性有機物として機能する有機素子。

【請求項8】

請求項1または請求項3に記載の有機素子において前記有機金属錯体化合物と前記電子受容性有機物が同一である有機素子。

【請求項9】

請求項1から8のいずれか1項に記載の有機素子において、前記熱還元性金属が、アルミニウム、ジルコニウム、シリコン、チタン及びタングステンから選択される少なくとも1種を含む有機素子。

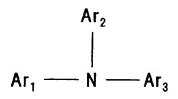
【請求項10】

請求項1から8のいずれか1項に記載の有機素子において、前記熱還元性金属が、マグネシウム、カルシウム、ストロンチウム、及びパリウムのアルカリ土類金属から選択される少なくとも1種を含み、かつ、前記有機金属錯体または前記無機化合物中に含有される4.0 eV以下の低仕事関数金属のイオンがアルカリ金属イオンである有機素子。

【請求項11】

請求項1から10のいずれか1項に記載の有機素子において、前記電子供与性を有する有機化合物がアリールアミン化合物であり、一般式(I):

【化1】



40

30

10

20

(式中、Ar, 及びAr, は、それぞれ独立に置換基を有してよい芳香族炭化水素基を表わす。)

で示されるアリールアミン化合物である有機素子。

【請求項12】

請求項1から10のいずれか1項記載の有機素子において、前記電子供与性を有する有機化合物が額料型有機物である有機素子。

【請求項13】

請求項12記載の有機素子において、前記電子供与性を有する有機化合物がポルフィリン化合物、または、その誘導体である有機素子。

【請求項14】

請求項12記載の有機素子において、前記電子供与性を有する有機化合物がキナクリドン化合物、またはその誘導体である有機素子。

【請求項15】

請求項12記載の有機素子において、前記電子供与性を有する有機化合物がインダンスレン化合物、またはその誘導体である有機素子。

【請求項16】

請求項11記載の有機素子において、前記電子供与性を有する有機化合物が、ガラス転移 点が90℃以上であるアリールアミン化合物である有機素子。

【請求項17】

請求項1から4のいずれか1項記載の有機素子において、前記電子供与性を有する有機化 10合物と酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成しうる無機物質が金属酸化物である有機素子。

【請求項18】

請求項1から4のいずれか1項記載の有機素子において、前記電子供与性を有する有機化合物と酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成しうる無機物質が金属ハロゲン化物である有機素子。

【請求項19】

請求項16記載の有機素子において、前記金属酸化物が5酸化パナジウム、7酸化2レニウム、3酸化モリブデン、又は3酸化タングステンである有機素子。

【請求項20】

請求項1から4のいずれか1項記載の有機素子において、前記電子供与性を有する有機化合物と酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成しうる有機物質が少なくとも1個のフッ素を置換基として有する有機素子。

【請求項21】

請求項1から4のいずれか1項記載の有機素子において、前記電子供与性を有する有機化合物と酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成しうる有機物質が少なくとも1個のシアノ基を置換基として有する有機素子。

【請求項22】

請求項20または請求項21記載の有機素子において、前記電子供与性を有する有機化合物と酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成しうる有機物質が少なくとも1個のシアノ 30基と、少なくとも1個のフッ素を置換基として同時に有する有機素子。

【請求項23】

請求項22記載の有機素子において、前記電子供与性を有する有機化合物と酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成しうる有機物質がテトラフルオローデトラシアノキノジメタンである有機素子。

【請求項24】

請求項1から4のいずれか1項記載の有機素子において、前記電子供与性を有する有機化合物と酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成しうる有機物質が少なくとも1個のホウ素原子を有している有機素子。

【請求項25】

40

20

請求項1から4のいずれか1項記載の有機素子において、前記電子供与性を有する有機化合物と酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成しうる有機物質が少なくとも1個のホウ素原子と、少なくとも1個のフッ素を同時に有している有機素子。

【請求項26】

請求項25記載の有機素子において、前記電子供与性を有する有機化合物と酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成しうる有機物質が、トリスβ-(ペンタフルオロナフチル)ボランである有機素子。

【請求項27】

請求項1から26のいずれか1項の有機素子において、有機EL素子を含む有機素子。

【請求項28】

請求項1から26のいずれか1項の有機素子において、有機太陽電池を含む有機素子。

【請求項29】

請求項1から26のいずれか1項の有機素子において、有機FET構造を含む有機素子。

【請求項30】

請 求 項 1 か ら•2 6 の い ず れ か 1 項 の 有 機 素 子 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 有 機 E L 素 子 。

【請求項31】

請求項1から26のいずれか1項の有機素子を含むことを特徴とする有機太陽電池。

【請求項32】

請求項1から26のいずれか1項の有機素子を含むことを特徴とする有機FET構造。

【請求項33】

仕事関数が4.0 e V以下の低仕事関数金属のイオンのうち少なくとも1種を含む有機金属錯体化合物と、前記有機金属錯体化合物中に含まれる金属イオンを真空中で金属状態に還元しうる熱還元性金属と、を積層もしくは共蒸着による混合により接触させてその場熱還元反応を起こし、

前記その場熱還元反応によって還元された低仕事関数金属と電子受容性有機物とを酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成して、前記電子受容性有機物がラジカルアニオン状態にある電子輸送部を形成する工程と、

イオン化ポテンシャルが 5.7 e V より小さく電子供与性を有する有機化合物と、前記有機化合物と酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成しうる無機物質又は有機物質と、を積層または混合により接触させ、

前記電子供与性を有する有機物がラジカルカチオン状態にあるホール輸送部を形成する工程と、

を備えることを特徴とする有機素子の製造方法。

【請求項34】

仕事関数が4.0eV以下の低仕事関数金属のイオンのうち少なくとも1種を含む無機化合物と、前記無機化合物中に含まれる金属イオンを真空中で金属状態に還元しうる熱還元性金属と、を積層もしくは共蒸着による混合により接触させてその場熱還元反応を起こし

前記その場熱還元反応によって還元された低仕事関数金属と電子受容性有機物とを酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成して、前記電子受容性有機物がラジカルアニオン状態 30 にある電子輸送部を形成する工程と、

イオン化ポテンシャルが 5.7 e V より小さく電子供与性を有する有機化合物と、前記有機化合物と酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成しうる無機物質又は有機物質と、を積層または混合により接触させ、

前記電子供与性を有する有機物がラジカルカチオン状態にあるホール輸送部を形成する工程と、

を備えることを特徴とする有機素子の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

[0001]

40

10

20

本発明は、有機エレクトロルミネッセント素子(以下、「有機EL素子」と略記することがある)、有機太陽電池、有機半導体(有機FET等)等、電荷輸送性有機物を使用する有機素子及びその製造方法に関する。

【背景技術】

[00002]

近年、有機半導体や有機導電体の研究が盛んに行われており、中でも有機半導体を使用する発光体である有機EL素子の進展がめざましい。

[0003]

有機EL素子において、Tangらは、素子の高効率化のため、キャリア輸送性の異なる有機化合物(ホール輸送性有機物と電子輸送性有機物)を積層し、ホールと電子がそれ 50

ぞれ陽極、陰極よりパランスよく注入される構造とし、しかも該陰極と陽極に挟まれた有機層の層厚を2000A以下とすることで、10V以下の印加電圧で1000cd/m²と外部量子効率1%の実用化に十分な高輝度、高効率を得ることに成功した(Appl.Phys.Lett.,51,913(1987)、特開昭59-194393号公報、特開昭63-264692号公報、特開平2-15595号公報、米国特許第4,539,507号明細書、同第4,769,292号明細書、同第4,885,211号明細書参照)。

[0004]

Tangらは、有機太陽電池においても、キャリア輸送性の異なる有機化合物(ホール輸送性有機物であるCuPcと電子輸送性有機物であるPV)を積層して、1%に近いパ 10ワー変換効率を実現している(Appl. Phys. Lett. 、48, 183 (1986))。

[0005]

最近では、これら有機デバイスの電極に挟まれた部分を複数積層して、回路的には直列に接続することで、素子の高効率化を図るアイディアが論文、及び特許文献中に散見されるに至っている(Appl. Phys. Lett.、80,1667(2002)、Chemistry Letters, pp. 327-330(1990)、特開平11-329748号公報、米国特許第6337492号明細書、特開2003-45676号公報、特開2003-264085号公報、等参照)。

[0006]

[0007]

特に本発明者は特開2003-272860号公報において、10°Ω c m以上の比抵 抗を有する電気絶縁性の電荷発生層を用いて複数の有機EL発光ユニットを回路的に直列 に接続する手法を開示し、MPE (Multi-Photon Emission) 有機 EL素子と名付けて、学会、展示会等の機会を利用して発表、展示を行い高い評価を得て きた (第49回応用物理学会関係連合講演会、講演予稿集27pーYLー3, p. 130 8、第63回応用物理学会学術講演会、講演予稿集27a-ZL-12, p. 1165、 Proceedings of EL2002 (International Con on the Science and Technology Emissive Display and Lighting) p. 539, P roceedings of IDMC'03 (International Dis play Manufacturing Conference) F r - 2 1 - 0 1p. 413, SID03 DIGEST, vol. XXXIV, воокіі. . 964. SID 03 DIGEST, vol. XXXIV, BOOKII, 9 7 9 、 第 1 3 回 フ ラ ッ ト パ ネ ル デ ィ ス プ レ オ 製 造 技 術 展 で の 講 演 会 D - 4 (2 0 0 3) 、 L C D / P D P I N T E R N A T I O N A L 2 0 0 2 での (株) アイメスの白色発光 体の展示及び配布資料、EExpress(2002年11月15日号)等参照)。

この電荷発生層の構造は、本発明者がこれまで蓄積してきた有機EL素子の電極に接する電荷(電子やホール)注入層の組成を、順次、積層したものと類似している。具体的には、特開平10-270171号公報(米国特許第6013384号明細書)や特開20 4001-102175号公報(米国特許第6589673号明細書)で開示した、電子受容性(電子輸送性)有機物をアルカリ金属等の還元性(電子供与性)物質で還元して生成する該電子受容性有機物のラジカルアニオン分子を含有する層と、特開平11-251067号公報(米国特許第6423429号明細書)や特開2001-244079号公報(米国特許第6589673号明細書)や特開2003-272860号公報、特願2003-358402号、特願2004-202266号明細書等で開示した、電子供与性(ホール輸送性)有機物をV₂〇5やMoO1やWO1や、

[化9]

で示される4F-TCNQや、

10

[化10]

20

で示されるPNB等の酸化性(電子受容性)物質で酸化して生成する該電子供与性有機物のラジカルカチオン分子を含有する層を順次積層した組成を有している(参照文献: K30. L. T. Dao and J. Kido, J. Photopolym. Sci. Technol., 15, 261 (2002))(参照資料: IDW '04. Advance Program, p. 60, OLED2-4, Novel Mg: Alq,/WO, Connecting Layer for Tandem White Organic Light Emitting Diodes (WOLEDs)、C.-C. Chang, S.-W. Hwang, H.-H. Chen, C. H. Chen, J.-F. Chen (2004))。

[0008]

この電荷発生層を介して従来型有機 E L 素子の陰極、陽極に挟まれた部分(発光ユニット)を積層すると、電圧印加時において、該電荷発生層から、陰極方向にホールが移動し、陽極方向に電子が移動するので、複数の発光ユニット中でホールと電子の再結合が生じ光子が発生する。結果として単位注入電流密度当たりの発光強度(例えば量子効率や電流効率)が略(n+1)倍になることが証明された(n は電荷発生層の層数)。

[0009]

この場合、駆動電圧も略 (n+1) 倍となるので、原理的には、電力変換効率はほとんど改善しない (変化しない) と予測された。

[0010]

しかしながら、厳密かつ詳細に検討すると、最適化された条件で作成されたMPE有機 EL素子構造は、電力変換効率においても相応の改善効果を実現できる。有機半導体は無機半導体に比べ電荷移動度が桁違いに低いため、所望の電流値を得るには「付加的な電圧 50 」を要することは周知である。ここで言う「付加的な電圧」とは、例えば、2eVの光子を放出するのに最低限必要な2Vのデバイス電圧を超えて、単位時間当たり、所望の、多量の光子を放出するために必要な電流密度を得るために'付加的に'必要とされる電圧(つまり、この場合は(駆動電圧-2V)=(付加的電圧))を言う。したがって、一般的に、輝度が電流密度のみに比例する有機EL素子を例にとれば、輝度の高い領域での電力変換効率は輝度の低い領域での電力変換効率よりも低下する(図24参照)。

しかしながら、MPE有機EL素子と従来の有機EL素子を同輝度において比較すれば、MPE素子の場合は所要電流密度が略 1 /(n + 1)、(n は電荷発生層の層数)となり、そのとき各(単位)発光ユニット当たり、消費される電位は、従来の有機EL素子で消費電力は低下することになる(つまり電力変換効率は上昇する)。図24に従来の有機EL素子構造を電荷発生層を介して2段(n=1)、5段(n=4)、10段(n=9)、と重ねた場合に、電力変換効率(1 m /W)が各輝度ごとにどのように変化するかをシミュレートしたものを示した。ここでは電流効率(c d / A)がきっちり(n + 1)倍となり、駆動電圧も、(同一輝度の時ではなく)同一電流密度の時に、きっちり(n + 1)倍(n は電荷発生層の層数)となる場合を示している。因みに従来構造の有機EL素子のデータ(1 段、n=0 の場合)は実際に作製した素子のデータである。

[0012]

このような良好な状態のMPE素子は簡単に実現されるわけではない。例えば、所望の電 20 流値を得るための電圧が従来構造の有機 EL素子の(n+1)倍以上となる場合、つまり、発光ユニットを電荷発生層を介して重ねるたびに、望ましくない「過剰電圧 (Δ V)」が加えられる事態が生じた場合は、当然のことながら電力変換効率も発光ユニットを重ねるたびに低下していくことになる。

[0013]

図25、図26に、発光ユニットを2個有するMPE有機EL素子のバンド図を示した。望ましくない「過剰電圧(ΔV)」は電荷発生層部分内部(本発明における「ホールー電子変換層」内部)で発生する。そもそも有機EL素子におけるホールの発生(または、注入)とは電子供与性分子(ホール輸送性分子)のHOMO(最高占有軌道)準位にたが引き抜かれた状態の生成、つまりラジカルカチオン分子の生成と同義である。したがするでMPE素子における電荷発生層の役割とは、電圧印加時に、該ラジカルアニオン分子の生成に伴って引き抜かれた電子を別の(陽極側の)発光ユニットの電子受容性分子(電子輸送性分子)のLUMO(最低非占有軌道)準位に注入することである。したがって可能である。したがって引きないに過剰電圧(ΔV)」は、該HOMO準位の電子が該LUMO準位に移動するである。この「HOMO準位の電子がLUMO準位に移動する」ことを別言すれば、「ホール電流を電子電流に変換する」と、表わすことができる。

[0014]

したがって、(「ホール-電子変換層」内部の)該エネルギー障壁を限りなく 0 にすることで、(結果的に)「過剰電圧(ΔV)」を限りなく 0 にすることが出来たときに、前述 40の良好な状態の M P E 有機 E L 素子を初めて実現出来ることになる(図 2 6)。

[0015]

本発明者は鋭意検討の結果、該エネルギー障壁を限りなく0にして、理想的な「ホール電流ー電子電流変換」を実現するに至った。 具体的には、特開平11-233262号公報や特開2000-182774号公報 (米国特許第6396209号明細書) (J. Endo, T. Matsumoto, and J. Kido, Jpn. J. Appl. Phys. Vol. 41(2002)pp. L800-L803参照) で詳説されている手法を用いて、熱還元反応によって電子受容性有機物のラジカルアニオン分子が生成して存在している熱還元反応生成層と、特開平11-251067号公報や特開20013-272860 号等で詳説されている手法を用いて形成した層(遠藤ら、Jpn.J.Appl.Phys.Vol.41(2002)L358、第47回高分子学会予稿集、47巻9号、p1940(1998)、Leoら、Appl.Phys.Lett.、vol.78、No.4、(2001)参照)、つまり、酸化性分子によって、電子供与性有機物のラジカルカチオン分子が生成している層と、を順次重ねることによって、(HOMO準位を流れる)ホール電流が(LUMO準位を流れる)電子電流に障壁なく、変換、されることが判明した。

[0016]

しかしながら、本発明者らが開示した、特開平10-270171号公報(米国特許第 6 0 1 3 3 8 4 号明細書)、特開 2 0 0 1 - 1 0 2 1 7 5 号公報 (米国特許第 6 5 8 9 6 10 73号明細書)、J. Kido and T. Matsumoto, Appl. Phys . Lett., 73, p. 2866 (1998)、等で詳説されている手法、すなわち、 アルカリ金属等の電子ドナー(環元性ドーパント)をドーピングすることで、電子受容性 有機物のラジカルアニオン分子を生成した場合は、該電子ドナー(還元性ドーパント)と 電子アクセプター(該酸化性分子)が直接に反応したり、前記電子受容性有機物と前記酸 化性分子の間や、前記電子供与性分子(ホール輸送性分子)と前記電子ドナー(還元性ド ーパント)の間にも、意図せずして、望ましくない反応が引き起こされ、結果として電子 の移動を妨げることが懸念され、実際に本発明者の検討によれば該MPE有機EL素子の 駆動 電圧が段数 (n+1)倍以上となってしまい、上記「過剰電圧(ΔV)」を 0 に出来 ないことが判明した。ここで、「駆動電圧が発光ユニットの重ね段数倍以上となってしま 20 い...」というのは、同電流密度(または、同輝度)を達成するための駆動電圧が発光ユ ニットの重ね段数倍以上となることを意味し、特に高電流密度(または、高輝度)領域に なるにしたがってその傾向が顕著となる(つまりΔVの値には電流密度依存性がある)。 このような望ましくない状態のMPE有機EL素子の実施例は、本発明者らによる特開2 003-45676号公報や、特開2003-272860号公報に開示されている。

[0017]

【特許文献1】特開昭59-194393号公報

【特許文献2】特開昭63-264692号公報

【特許文献3】特開平2-15595号公報

【特許文献4】特開平10-270171号公報

【特許文献 5】 特開平 1 1 - 2 3 3 2 6 2 号公報

【特許文献 6 】 特開平 1 1 - 2 5 1 0 6 7 号 公報

【特許文献7】特開平11-329748号公報

【特許文献8】特開2000-182774号公報

【特許文献9】特開2001-102175号公報

【特許文献10】特開2001-244079号公報

【特許文献11】特開2003-45676号公報

【特 許 文 献 1 2 】 特 開 2 0 0 3 - 2 6 4 0 8 5 号 公 報

【特許文献13】特開2003-272860号公報

【特許文献14】米国特許第4,539,507号明細書

【特許文献 1 5 】 米国特許第 4 , 7 6 9 , 2 9 2 号明細書

【 特 許 文 献 1 6 】 米 国 特 許 第 4 , 8 8 5 , 2 1 1 号 明 細 書

【特許文献17】米国特許第6,337,492号明細書

【非特許文献1】Appl. Phys. Lett., 51, 913 (1987)

【非特許文献 2】 Appl. Phys. Lett., 48, 183 (1986)

【非特許文献 3】 Chemistry Letters, pp. 327-330 (1990)

【非特許文献 4】 J. Kido and T. Matsumoto, Appl. Phys. Lett., 73, p. 2866 (1998)

【非特許文献 5 】 第 4 7 回 高 分 子 学 会 予 稿 集 、 4 7 巻 9 号 、 p 1 9 4 0 (1 9 9 8)

40

30

40

【非特許文献 6】 Leoら、Appl. Phys. Lett., vol. 78, No. 4(2001)【非特許文献 7】 Appl. Phys. Lett., 80, 1667 (2002)

【非特許文献 8】 K. L. T. Dao and J. Kido, J. Photopo Lym Sci Technol 15 261 (2002)

lym. Sci. Technol., 15, 261 (2002)

【非特許文献 9】 J. Endo, T. Matsumoto, and J. Kido, Jpn. J. Appl. Phys. Vol. 41 (2002) pp. L800-L803

【非特許文献 1 0 】遠藤ら、Jpn. J. Appl. Phys. Vol. 4 1 (2 0 0 2) L 3 5 8

【非特許文献 1 1 】 第 4 9 回応用物理学会関係連合講演会、講演予稿集 2 7 p - Y L - 3 10 , p . 1 3 0 8

【非特許文献 1 2 】 第 6 3 回応用物理学会学術講演会、講演予稿集 2 7 a - Z L - 1 2, p. 1 1 6 5

【非特許文献 13】 Proceedings of EL2002 (International Conference on the Science and Technology of Emissive Display and Lighting)
p. 539

【非特許文献 14】 Proceedings of IDMC'03 (International Display Manufacturing Conference) Fr-21-01 p. 413、SID03 DIGEST, vol. XXXIV, 20 BOOKII, p. 964

【非特許文献 15】SID 03 DIGEST, vol. XXXIV, BOOKII , p. 979

【非特許文献 16】 IDW '04 Advance Program, p. 60, OLE D2-4, Novel Mg: Alq3/WO3 Connecting Layer for Tandem White Organic Light Emitting Diodes (WOLEDs)、C. - C. Chang, S. - W. Hwang, H. - H. Chen, C. H. Chen, J. - F. Chen (2004)

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0018]

本発明の目的は、下記に記載する電子輸送部としての層とホール輸送部としての層の2つの層を連続して積層させた「ホール電流ー電子電流変換層」(「ホールー電子変換層」)を、MPE有機EL素子の電荷発生層のみならず、従来型有機太陽電池を複数個、直列につなぐ「接続層」として用いたり、さらには一般的な有機素子の電極形成時のパッファー層として用いたりと、この層(が持つ利点)を一般化して広範囲に使用することで、従来型有機素子の持つ欠点を克服することにある。

【課題を解決するための手段】

[0019]

電子受容性有機物をラジカルアニオン分子とするために、

(1)「アルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン、希土類金属イオン、及び一部の遷移金属イオンを代表とする、仕事関数が4.0 e V以下の低仕事関数金属のイオンのうち、少なくとも1種を含む化合物(有機物でも無機物でもよい)」と、「(アルミニウムのように)該化合物に含まれる金属イオンを真空中(例えば蒸着チャンパー内の雰囲気)で金属状態に還元しうる熱還元性金属」とを、(真空蒸着による)積層、もしくは、共蒸着による混合により接触させて反応させ、該熱還元反応によって還元された低仕事関数金属と、その近傍に存在する電子受容性有機物とを(電子の授受による)酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成させて、該電子受容性有機物がラジカルアニオン状態にある電子輸送部(熱還元反応生成部)と、

(2) (a) イオン化ポテンシャルが 5.7 e V より小さく、電子供与性すなわちホール 50

翰 送 性 を 有 す る 有 機 化 合 物 と 、 (b) (a) の 有 機 化 合 物 と 、 (電 子 の 授 受 に よ る) 酸 化 還元反応によって電荷移動錯体を形成しうる無機物質又は有機物質とが、積層、または混 合されて接触しており、(a)の電子供与性有機物がラジカルカチオン状態にあるホール 輸 送 部 、 と が 積 層 さ れ て な る 「 ホ ー ル 電 流 - 電 子 電 流 変 換 層 」 (「 ホ ー ル - 電 子 変 換 層 」)を有していればよく、この層の使用法は特に限定されない。

[0020]

本発明の有機素子は、仕事関数が4.0 e V以下の低仕事関数金属のイオンのうち少な く と も 1 種 を 含 む 有 機 金 属 錯 体 化 合 物 と 、 有 機 金 属 錯 体 化 合 物 中 に 含 ま れ る 金 属 イ オ ン を 真 空 中 で 金 属 状 態 に 還 元 し う る 熱 還 元 性 金 属 と 、 を 積 層 も し く は 共 蒸 着 に よ る 混 合 に よ り 接触させて引き起こされたその場熱還元反応によって還元された低仕事関数金属と電子受 10 容性有機物とが酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成して、電子受容性有機物がラジ カルアニオン状態にある電子輸送部、及び、イオン化ポテンシャルが5.7eVより小さ く 電 子 供 与 性 を 有 す る 有 機 化 合 物 と 、 有 機 化 合 物 と 酸 化 還 元 反 応 に よ っ て 電 荷 移 動 錯 体 を 形成しうる無機物質又は有機物質と、が積層または混合されて接触しており、電子供与性 を有する有機物がラジカルカチオン状態にあるホール輸送部、

が積層されてなるホール電流ー電子電流変換層を含むことを特徴としている。

[0021]

本 発 明 の 有 機 素 子 は 、 仕 事 関 数 が 4. 0 e V 以 下 の 低 仕 事 関 数 金 属 の イ オ ン の う ち 、 少 な く と も 1 種 を 含 む 無 機 化 合 物 と 、 無 機 化 合 物 中 に 含 ま れ る 金 属 イ オ ン を 真 空 中 で 金 属 状 態に還元しうる熱還元性金属と、を積層もしくは共蒸着による混合により接触させて引き 起 こ さ れ た そ の 場 熱 還 元 反 応 に よ っ て 還 元 さ れ た 低 仕 事 関 数 金 属 と 電 子 受 容 性 有 機 物 と が 酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成して、電子受容性有機物がラジカルアニオン状 態 に あ る 電 子 輸 送 部 (熱 還 元 反 応 生 成 部) 、 及 び 、 イ オ ン 化 ポ テ ン シ ャ ル が 5. 7 e V よ り 小 さ く 電 子 供 与 性 を 有 す る 有 機 化 合 物 と 、 有 機 化 合 物 と 酸 化 還 元 反 応 に よ っ て 電 荷 移 動 錯体を形成しうる無機物質又は有機物質とが、積層または混合されて接触しており、電子 供 与 性 を 有 す る 有 機 物 が ラ ジ カ ル カ チ オ ン 状 態 に あ る ホ ー ル 輪 送 部 、 が 積 層 さ れ て な る ホ ール電流ー電子電流変換層を含むことを特徴としている。

[0022]

本発明の有機素子は、電子輸送部と、ホール輸送部と、を積層してなるホール電流-電 子電流変換層を含み、電子輸送部は、仕事関数が4.0eV以下の低仕事関数金属のイオ ン の う ち 少 な く と も 1 種 を 含 む 有 機 金 属 錯 体 化 合 物 と 、 有 機 金 属 錯 体 化 合 物 に 対 し て 積 層 もしくは共蒸着による混合により接触し、有機金属錯体中に含まれる金属イオンを真空中 で 金 属 状 態 に 還 元 し う る 熱 還 元 性 金 属 と 、 を 有 し 、 接 触 に よ り 引 き 起 こ さ れ た そ の 場 熱 環 元反応によって還元された低仕事関数金属と電子受容性有機物とが酸化還元反応によって 電 荷 移 動 錯 体 を 形 成 し て 、 電 子 受 容 性 有 機 物 が ラ ジ カ ル ア ニ オ ン 状 態 に あ り 、 ホ ー ル 輪 送 層は、イオン化ポテンシャルが5.7eVより小さく電子供与性を有する有機化合物と、 有機化合物に対して積層または混合されて接触し、有機化合物と酸化還元反応によって電 荷 移 動 錯 体 を 形 成 し う る 無 機 物 質 又 は 有 機 物 質 と 、 を 有 し 、 電 子 供 与 性 を 有 す る 有 機 物 が ラジカルカチオン状態にあることを特徴としている。

[0023]

本発明の有機素子は、電子輸送部と、ホール輸送部と、を積層してなるホール電流ー電 子電流変換層を含み、電子輸送部は、仕事関数が4.0eV以下の低仕事関数金属のイオ ン の う ち 少 な く と も 1 種 を 含 む 無 機 化 合 物 と 、 無 機 化 合 物 に 対 し て 積 層 も し く は 共 蒸 着 に よる混合により接触し、有機金属錯体中に含まれる金属イオンを真空中で金属状態に還元 し う る 熱 還 元 性 金 属 と 、 を 有 し 、 接 触 に よ り 引 き 起 こ さ れ た そ の 場 熱 環 元 反 応 に よ っ て 環 元された低仕事関数金属と電子受容性有機物とが酸化還元反応によって電荷移動錯体を形 成して、電子受容性有機物がラジカルアニオン状態にあり、ホール輸送層は、イオン化ポ テンシャルが 5.7 e V より小さく電子供与性を有する有機化合物と、有機化合物に対し て積層または混合されて接触し、有機化合物と酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成 しうる無機物質又は有機物質と、を有し、電子供与性を有する有機物がラジカルカチオン 50

20

30

40

状態にあることを特徴としている。

[0024]

上記有機金属錯体化合物と電子受容性有機物は積層または混合されて接触していることが好ましい。

[0025]

上記無機化合物と電子受容性有機物も積層または混合されて接触していることが好ましい。

[0026]

上記有機金属錯体化合物中で金属イオンに配位もしくは結合している有機分子部分(部位)は電子受容性有機物として機能していても良い。

[0027]

上記有機金属錯体化合物と電子受容性有機物は、同一であっても良い。

[0028]

上記熱還元性金属は、アルミニウム、ジルコニウム、シリコン、チタン及びタングステンから選択される少なくとも1種を含むことが望ましい。

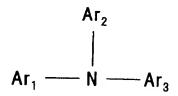
[0029]

上記金属錯体化合物または上記無機化合物に含まれる低仕事関数金属のイオンがアルカリ金属イオンである場合は、上記熱還元性金属は、マグネシウム、カルシウム、ストロンチウム、及びバリウムのアルカリ土類金属から選択される少なくとも 1 種を含む金属であっても良い。

[0030]

上記電子供与性有機化合物は、アリールアミン化合物であり、一般式(Ⅰ):

【化1】



(式中、Ar,及びAr,は、それぞれ独立に置換基を有してよい芳香族炭化水素基を表わす。)

で示されるアリールアミン化合物であるとよい。

[0031]

上記電子供与性有機化合物は顔料型有機物であることが好ましい。

[0032]

上記電子供与性有機化合物は、ポルフィリン化合物またはその誘導体であるとよい。

[0033]

上記電子供与性有機化合物は、キナクリドン化合物またはその誘導体であることが好ましい。

[0034]

上記電子供与性有機化合物は、インダンスレン化合物またはその誘導体であることが好ましい。

[0035]

上記電子供与性有機化合物は、ガラス転移点が90℃以上であるアリールアミン化合物であるとよい。

[0036]

上記、電子供与性を有する有機化合物と酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成しうる無機物質は、金属酸化物であることが好ましい。

[0037]

上記、電子供与性を有する有機化合物と酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成しうる無機物質は、金属ハロゲン化物であることが好ましい。

[0038]

上記、電子供与性を有する有機化合物と酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成しうる金属酸化物は、V,O,(5酸化バナジウム)、7酸化2レニウム、MoO,(3酸化モリブデン)、又はWO,(3酸化タングステン)であることが好ましい。

[0039]

上記電子供与性を有する有機化合物と酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成しうる金属ハロゲン化物は、塩化第2鉄、臭化第2鉄、等の鉄ハロゲン化物や、アルミニウムハロゲン化物、ガリウムハロゲン化物、インジウムハロゲン化物、アンチモンハロゲン化物 10、又は、ヒ素ハロゲン化物から適宜選択されることが好ましい。

[0040]

上記、電子供与性を有する有機化合物と酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成しうる有機物質は、少なくとも1個のフッ素を置換基として有するとよい。

[0041]

上記、電子供与性を有する有機化合物と酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成しうる有機物質は、少なくとも1個のシアノ基を置換基として有することが好ましい。

[0042]

上記、電子供与性を有する有機化合物と酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成しうる有機物質は、少なくとも1個のシアノ基と、少なくとも1個のフッ素を置換基として同 20時に有することが好ましい。

[0043]

上記、電子供与性を有する有機化合物と酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成しうる有機物質は、テトラフルオローテトラシアノキノジメタンであることが好ましい。

[0044]

上記、電子供与性を有する有機化合物と酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成しうる有機物質は、少なくとも1個のホウ素原子を有していることが好ましい。

[0045]

上記、電子供与性を有する有機化合物と酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成しうる有機物質は、少なくとも1個のホウ素原子と、少なくとも1個のフッ素を同時に有して 30 いるとよい。

[0046]

上記、電子供与性を有する有機化合物と酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成しうる有機物質は、トリスβ- (ペンタフルオロナフチル)ボランであるであることが好ましい。

[0047]

本発明の有機素子は、有機EL素子を含むことを特徴としている。

[0048]

本発明の有機素子は、有機太陽電池を含むことを特徴としている。

[0049]

本発明の有機素子は、有機FET構造を含むことを特徴としている。

[0050]

本発明の有機EL素子は、上記有機素子を含むことを特徴としている。

[0051]

本発明の有機太陽電池は、上記有機案子を含むことを特徴としている。

[0052]

本発明の有機FET構造は、上記有機素子を含むことを特徴としている。

[0053]

本発明の有機素子の製造方法は、仕事関数が4.0 e V以下の低仕事関数金属のイオンのうち少なくとも1種を含む有機金属錯体化合物と、有機金属錯体化合物中に含まれる金 50

属イオンを真空中で金属状態に還元しうる熱還元性金属と、を積層もしくは共蒸着による混合により接触させてその場熱還元反応を起こし、その場還元反応によって還元された低仕事関数金属と電子受容性有機物とを酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成して、電子受容性有機物がラジカルアニオン状態にある電子輸送部を形成する工程と、イオン化ポテンシャルが5.7eVより小さく電子供与性を有する有機化合物と、有機化合物と酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成しうる無機物質又は有機物質と、を積層または混合により接触させ、電子供与性を有する有機物がラジカルカチオン状態にあるホール輸送部を形成する工程と、を備えることを特徴としている。

[0054]

本発明の有機素子の製造方法は、仕事関数が4.0eV以下の低仕事関数金属のイオンの 10 うち少なくとも1種を含む無機化合物と、無機化合物中に含まれる金属イオンを真空中で金属状態に還元しうる熱還元性金属と、を積層もしくは共蒸着による混合により接触させてその場熱還元反応を起こし、その場還元反応によって選元された低仕事関数金属と電子受容性有機物とを酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成して、電子受容性有機物がラジカルアニオン状態にある電子輸送部を形成する工程と、イオン化ポテンシャルが5.7eVより小さく電子供与性を有する有機化合物と、有機化合物と酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成しうる無機物質又は有機物質と、を積層または混合により接触させ、電子供与性を有する有機物がラジカルカチオン状態にあるホール輸送部を形成する工程と、を備えることを特徴としている。

【発明の効果】

[0055]

電子輸送部としての層とホール輸送部としての層を連続して積層させた「ホール電流一電子電流変換層」(「ホールー電子変換層」)を、MPE有機EL素子の電荷発生層のみならず、従来型有機太陽電池を複数個、直列につなぐ「接続層」として用いたり、さらには一般的な有機素子の電極形成時のバッファー層として用いたりと、この層(が持つ利点)を一般化して広範囲に使用することで、従来型有機素子の持つ欠点を克服することができる。

[0056]

熱還元反応生成層(電子輸送部)中では、アルミニウムやマグネシウム等の熱還元性金属はすでに金属原子として存在しておらず、イオン状態(酸化状態)として存在している 30 ため、下記の実施例に見られるように良好な透明性を付与することができる。

[0057]

アルカリ金属を代表とする還元性ドーパントは大気中で発火するほど反応活性なものがほとんどなので、本発明の手法はそのような金属のハンドリングが不要になる、という工程上の優位点がある。

[0058]

透明性が高く、かつ、発明者らが特開平10-270171号公報や特開2001-10 2175号公報等で開示した、還元性ドーパントがドーピングされた電子輸送層と略同等 の比抵抗を有する膜を得ることが可能である。

【発明を実施するための最良の形態】

[0059]

<第1実施形態>

第1 実施形態においては、電子輸送部(熱還元反応生成部)の構成物質として、アルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン、希土類金属イオン及び一部の遷移金属イオンを代表とする仕事関数が4.0 e V以下の低仕事関数金属(アルカリ金属)のイオン含有有機物として、

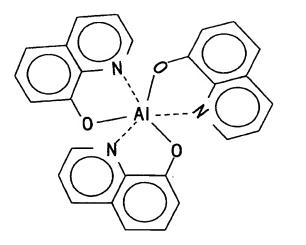
20

[化2]

で示される、 (8-キノリノラト) リチウム錯体 (以下、Liaと略記することがある) を使用し、

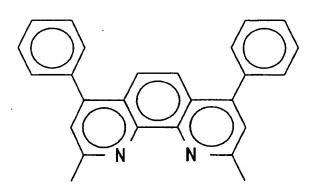
さらに、電子受容性(輸送性)有機物として、

[化3]



で表されるトリス(8-キノリノラト)アルミニウム錯体(以下、Alaと略記すること がある)、もしくは

[化4]



で示されるバソクプロイン(以下、BCPと略記することがある)の様な有機物を、あら かじめ共蒸着の手法により混合層として形成しておき、さらにその混合層上に代表的熱還 元性金属であるアルミニウムを適量真空蒸着するのが好適な形成方法の一つである。この 時、アルミニウム金属はアルカリ金属イオン (LiqではLi')を還元 (その場 (in - s i t u) 還 元 反 応) す る の で 自 ら は 、 当 然 、 酸 化 状 態 に 変 化 す る (ア ル ミ ニ ウ ム イ オ ン含有化合物となる)。さらに還元されて生成したLi金属は近傍に存在する電子受容性 (ホール輸送性) 有機物 (例えばAlg) と電子の授 受による酸 化還元反応によって ((Li+Alq →) Li' + Alq (ラジカルアニオン)) の電荷移動錯体を形成す る。ここで、生成したラジカルアニオンが電子電流の担い手(内部電荷)として振る舞え 50

30

る分けである。

[0060]

このようにして生成した、熱選元反応生成層は(純粋な有機物と比べても)一般に、透明 性が高く、さらに純粋な有機物と比べ比抵抗が低下する(つまり、導電性が上昇する)特 徴がある。このような導電性の上昇は、 該プロセスが「アルミニウムの様な金属を混入す るプロセスであるから」、とする誤解を生ずることがあるが、上記のように、該熱還元反 応 生 成 層 中 で は 、 既 に ア ル ミ ニ ウ ム は 金 属 原 子 と し て 存 在 し て お ら ず 、 イ オ ン 状 態 (酸 化 状態)として存在している。したがって良好な透明性が付与される分けである。導電性の 向上の要因は、上記Al q (ラジカルアニオン) の生成に起因している (実施例4.5 参照)。

[0061]

アルミニウム等の熱還元性金属の量はアルカリ金属イオン含有化合物中のイオンを金属に 還元するための「過不足のない量」が好ましく、この量が少ないと十分に該熱還元反応を 起 こ す こ と が 出 来 ず に 、 結 果 と し て 電 子 受 容 性 (輸 送 性) 有 機 物 が ラ ジ カ ル ア ニ オ ン と な る こ と が 出 来 な い し 、 過 剰 で あ る と 該 熱 還 元 反 応 に 寄 与 出 来 な い (つ ま り 酸 化 状 態 に 変 化 出来ない)金属アルミニウムが残存するため、膜の透明性を低下させるので所望の効果が 期待出来なくなる。このような現象を示す例を下記実施例4に示した。

[0062]

<第2実施形態>

第 2 実 施 形 態 に お い て は 、 電 子 輸 送 部 (熱 還 元 反 応 生 成 部) の 構 成 物 質 と し て 、 第 1 実 施 20 形態と同様に低仕事関数金属(アルカリ金属)イオン含有化合物として、Liaの様なア ルカリ金属イオン含有有機金属錯体と、Alqの様な電子受容性(輸送性)有機物と、さ らにアルミニウムのような熱還元性金属を同時に蒸着して混合させて(3元共蒸着)、上 記と同様の機能を持つ電子輸送部を作成することも可能である。この場合該3つの物質の 蒸 着 比 率 を 適 正 に 制 御 す る こ と で 、 透 明 性 が 高 く 、 か つ 本 発 明 者 が 特 開 平 1 0 - 2 7 0 1 7 1 号公報や特開 2 0 0 1 - 1 0 2 1 7 5 号公報等で開示した還元性ドーパントがドーピ ングされた電子輸送層と略同等の比抵抗を有する膜を得ることが可能である(実施例5参 照)。言うまでもなく、アルカリ金属を代表とする該還元性ドーパントは大気中で発火す るほど反応活性なものがほとんどなので、本発明の手法はそのような金属のハンドリング が不要になる、という工程上の優位点がある。

[0063]

<第3実施形態>

第3実施形態においては、電子輸送部(熱還元反応生成部)の構成物質として、

10

[化5]

で、示されるトリ(1、3-フェニル-1、3-プロパンジオナト)モノ(バソフェナントロリン)ユウロピウム錯体(以下、「Eu(DBM)3・BPEHEN」と略記することがある)の様な希土類金属イオン含有有機金属錯体であって、配位子の一つに

【化6】

で示されるパソフェナントロリン(以下、BPHEN)の様な、それ自身に電子受容性(輸送性)を有する化合物を有している場合は、

Eu (DBM) 3・BPEHENの化合物と熱還元性金属であるアルミニウムを同時に蒸着して混合させ(2元共蒸着)、上記と同様の機能を持つ電子輸送部を作成することも可能である。この場合も、該2つの物質の蒸着比率を適正に制御することで、透明性が高く、かつ本発明者が特開平10-270171号公報や特開2001-102175号公報等で開示した、還元性ドーパントがドーピングされた電子輸送層と略同等の比抵抗を有する膜を得ることが可能である(Euの酸化によるBPHEN(ラジカルアニオン)の生成)。

[0064]

<第4実施形態>

第4実施形態においては、上記Li q の様に、アルカリ金属イオンを含有して、かつ、それ自身が電子受容性(輸送性)を併せ持つ化合物である場合は、熱還元性金属であるアルミニウムと適当な比率で同時に蒸着して混合させ(2元共蒸着)、上記と同様の機能を持つ電子輸送部を作成することも可能である。この場合は、アルミニウムによって熱還元されないLi q が残存していることが想定されており、酸化還元反応によって(Li'+Li q ・ (ラジカルアニオン))の電荷移動錯体を形成する。

もちろん、上記のアルカリ金属イオンや、希土類金属イオンのような低仕事関数金属のイオン含有化合物であれば、上記有機金属錯体に代えて無機化合物を使用してもよい。

40

[0065]

上記の実施形態 1 ~ 4 に示される電子輸送部に隣接して形成される本発明のホール輸送部は、既にこれまで有機 E L 素子のホール注入層やホール輸送層中で広く使用されている、イオン化ポテンシャルが 5 . 7 e V より小さく電子供与性を有する有機化合物と、前記有機化合物と酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成しうる無機物質又は有機物質と、が積層または混合されて接触しており、前記電子供与性を有する有機化合物がラジカルカチオン状態にあるホール輸送部となっている。

[0066]

なお、有機化合物、金属、及び「ホール電流 - 電子電流変換層」の成膜には、日本ピーテック製真空蒸着機を使用した。蒸着物質の成膜速度の制御や膜厚の制御は該蒸着機に取付 10 けられている、水晶振動子を使用した成膜モニターCRTM-8000(ULVAC(日本真空技術社)製)を使用した。また、成膜後の実質膜厚の測定には、テンコール(Tencor)社製P10触針式段差計を用いた。素子の特性評価には、ケースレー(KEITHLEY)社ソースメータ2400、トプコンBM-8輝度計を使用した。また、吸収スペクトルの測定は、パーキンエルマー製:ラムダ19を使用して測定した。

[0067]

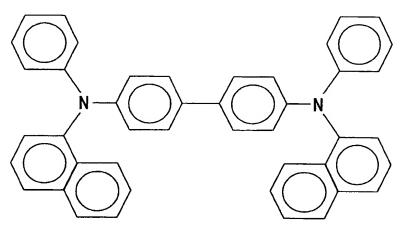
以下に実施例を挙げて本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はこれにより限定されるものではない。

【実施例1】

[0068]

実施例 1 は、陰極に接する層に、本発明の「ホール電流ー電子電流変換層」を有しており、結果的に、ホール電流の流れる層が陰極に接している有機 E L 素子の例である。この例では、図 1 に示すように、ガラス基板 1 0 上にパターニングされた I T O (I n d i u m T i n O x i d e)陽極 1 1 上に、下記式

【化7】



[0069]

次に、上記Alq(低仕事関数金属イオン含有化合物)とLiqを、モル比率1:1で50Aの厚さに成膜した(層14)。さらにその上から熱還元性金属であるアルミニウムを15A(に相当する量)蒸着した(層15)。次に上記αNPDと5酸化パナジウム(V₁O₃)をモル比率1:1で100Aの厚さで成膜した(層16)(ホール輸送部)。最後に陰極金属17としてアルミニウムを1000Aの厚さで成膜した。

[0070]

この有機EL素子210の構造を簡便に表記すると、

20

ITO/αNPD (600Å) / Alq (600Å) / Alq:Liq (1:1) (50Å) / Al (15Å) / V₂O₃:αNPD (1:1) (100Å) / Al (図1) となる。以下の説明ではこのような(簡便な)表記法を用いることとする。

[0071]

この有機EL素子210において、陽極電極であるITOと陰極電極であるAIとの間に、直流電圧を印加して、諸特性を測定した結果を図3に示す。図3の〇プロットは、この素子の電圧(V) - 電流密度(m A / c m²) - 輝度(c d / m²) 特性を示す。また、この素子の動作概念を示した図2に示すように、層14及び層15は、電子輸送部(熱選元反応生成層)18として、層16と層18はホール電流 - 電子電流変換層19として機能する。

[0072]

<比較例1>

比較例1は、実施例1と比較するため、本発明の電子輸送部である熱還元反応生成層18 を用いない構造、すなわち、実施例1の層14のLiqに代えて金属Liを層104に使用した例であり、その素子300の構造は

ITO/ α NPD (600Å)/Alq (600Å)/Alq:Li(1:1) (50Å)/ ν V₂O₅: α NPD (1:1) (100Å)/Al (ν A)

となっている。この有機EL素子300の諸特性を測定した結果を図3の●プロットで示す。

【実施例2】

[0073]

実施例2においては、実施例1の層14のしiqに代えて、

[化8]

$$C (CH_3)_3$$

$$C (CH_3)_3$$

$$C (CH_3)_3$$

で示される、モノ (2, 2, 6, 6 - テトラメチル - 3, 5 - ヘプタンジオナト) ルビジウム錯体 (以下、Rb (dpm) と略記することがある) を層 2 4 に使用しており、ITO/αNPD (600Å) / Alq: Rb (dpm) (1:1)

) (50Å) / A1 (15Å) / V,O,: α N P D (1:1) (100Å) / A1 (図 5)

なる構造の素子 2 2 0 を作成した。この有機 E L 素子 2 2 0 の諸特性を測定した結果を図 3 の▼プロットで示す。

【実施例3】

40

10

20

30

[0074]

実施例3においては、実施例1の層14のLiqに代えてアルカリ金属の無機化合物であるLiF(フッ化リチウム)を層34に使用して、

ITO/αNPD (600Å)/Alq (600Å)/LiF (10Å)/Al (15Å)/V,O;: αNPD、(100Å)/Al (図6)

なる構造の素子 2 3 0 を作成した。この構造は電子 受容性化合物である A 1 q (層 1 3) とアルカリ金属化合物のLiF(層 3 4)が、(混合ではなく)積層されて接触している 。この有機 E L 素子 2 3 0 の諸特性を測定した結果を図 3 の Δ プロットで示す。

[0075]

<参考例1> (従来型の有機EL素子の例)

なる構造となっている(図7)。この有機EL素子の諸特性を測定した結果を図3の◆プロットで示す。

[0076]

実施例1~3、比較例1、参考例1の結果を比較すると、本発明の「ホール電流-電子電流変換層」を有する有機EL素子は従来型の素子と比べても遜色なく機能し、むしろ、より低電圧で駆動出来ることが分かった。また、アルカリ金属のような還元性ドーパントを使用すると、ホール電流-電子電流変換層内部に、エネルギー障壁が生成してしまうため、同電流密度、または同準度を達成するために必要な電圧が高くなることが示された。

【実施例4】

[0077]

実施例4として、熱還元性金属の役割を確認し、かつ、その最適蒸着量(もしくは最適 膜厚)を確認する実験を行った。

実施例1の構造を基準にして、熱還元性金属であるアルミニウムの蒸着量を変化させて、有機EL素子としての特性の変化を調べた。すなわち

の構造で、AIの層15の膜厚(XÅ)を変化させた。

[0078]

図8、図9の▽プロットはX=0 (つまりアルミニウムを蒸着しない場合)のとき、◆プロットはx=3Åのとき、メプロットはX=10Åのとき、○プロットはX=15Åのとき、△プロットはX=20Åのときの各素子の、電圧 (V) -電流密度 (mA/cm²) -輝度 (cd/m²)特性 (図8)、電流密度 (mA/cm²) -電流効率 (cd/A) (図9)を示す。

[0079]

この結果から、熱還元性金属の蒸着量が所定量より少ないと、発光が観測されないことが 30 示された(x = 0 Å, もしくは3 Åの場合に対応)。これは、熱還元反応生成層内で電子受容性有機物のラジカルアニオン分子が生成されなかったため、発光層内に電子が注入されなかったためである。したがって、この時観測された電流はホール電流のみの電流である(2.2 V近辺に発光開始電圧を示唆する 'キンク (Kink)'が観測されないという事実からも、そのことが裏付けられる。)。

[0800]

また、図8、図9のグラフに示される結果から、この実験の範囲内ではアルミニウムを15Aの膜厚に相当する量に制御すると、輝度や効率が最も高い値を示すことが分かった。それ以上にアルミニウムの蒸着量を増やすと、熱還元反応に寄与しない(つまり酸化状態に変化出来ない)金属アルミニウムが残存して素子特性を低下させることが示された。 【実施例5】

[0081]

実施例 5 は、低仕事関数金属のイオン含有化合物と、電子受容性有機物と、熱還元性金属を同時に蒸着(3元共蒸着)して「透明性」と「導電性」を付与させた例である。A 1 がパターニングされたガラス基板 5 0 と、吸光度測定用の石英基板 5 6 をそれぞれ用意して、以下の手順で蒸着成膜を行った。

[0082]

まず、低仕事関数有機金属錯体であるLiqと、電子受容性有機物であるAlqと、熱 還元性金属であるAl (アルミニウム) を、Al電極 5 1 上に、膜厚速度比で、 (Liq :Alq:Al=1 A/s (Liq):3 A/s (Alq):0.3 A/s (Al)) と 50

30

なるように共蒸着して層52を形成し、さらにA1電極53を生成し、

Al/Liq:Alq:Al/Al (図10)

の構造の素子250を作成した。

[0083]

ま た 、 比 較 用 素 子 と し て 、 上 記 層 5 2 に 代 え て 、 ア ル カ リ 金 属 と し て L i を 直 接 電 子 受 容性有機物(A·lq)と混合して層54を生成した、

A l / A l q : L i (1:1, モル比率) / A l (図11)

の構造の素子251を作成した。

また、上記層 5 2 に代えて、Alq 単独 膜 5 5 を電極 5 1 、 5 3 で挟んだ、

A 1/A 1 q/A 1 ($\boxtimes 1 2$)

の構造の素子252を作成して、それぞれ、電場(V/cm) - 電流密度(A/cm¹) 特性を測定した(図15)。

[0084]

図 1 5 のグラフに示される通り、(A l / L i q : A l q : A l / A l)(図 1 0)の 構造の素子と、(A l / A l q : L i (1 : 1 , モル比率) / A l) (図 1 l i) の構造の 素子は、略同等の特性を示し、~10'Ω cmの比抵抗を示すことが分かった。これはΑ l によってLi q 中のLiイオンが熱還元反応によって金属に還元され、ついで還元され たLi金属が電子受容性有機物である、Alaと電子の授受(酸化還元反応)によって電 荷移動錯体 (Li'+Alq (ラジカルアニオン)) を形成したことを示している。

[0085]

20 また、吸光度(及び、透過率)測定用素子として、石英基板56上にLig:AlQ: Alを共蒸着して

石英基板/Lia:Ala:Al、(図13)

なる構造の素子255を作成した。この素子255は、石英基板56上に、膜厚速度比で , (Liq:Alq:Al=1 Å/s (Liq):3 Å/s (Alq):0.3 Å/s (Al))となるように共蒸着して層52を形成した。

また、比較用素子256として、熱還元性金属であるA1を混入させずに、石英基板56 上にLiq:Alq(層57)を共蒸着して

石英基板/Liq:Alq の素子を作成した。(図14)

[0086]

図16は、上記吸光度測定用素子(図13)と比較用素子(図14)について、層52 (Liq:Alq:Al) 及び層 5 7 (Liq:Alq) を 1 0 0 0 Åとしたときの波長 (nm) - 透過率 (%) 特性を測定した結果を示している。 図 1 6 に示されるとおり、本 発明の電子輸送部である(Lia:Ala:Al)(層52)からなる混合膜は、有機物 のみからなる (Liq: Alq) (層 5 7) と比べて、同じ膜厚 (1 0 0 0 Å) 当たりの 透過率が大きく上昇することが確かめられた。また、本発明者は、前出の論文誌Appl Phys. Lett.、73、p. 2866(1998)中でリチウム金属ドーピング 膜の吸収スペクトルの変化を示しているが、図17に示されるとおり、本発明の、(石英 基板/Lia:Ala:Al)(吸光度測定用素子(図13))の吸収スペクトルと(石 英基板/Lia:Ala)(比較用素子(図14))の吸収スペクトルの変化は、 該論文 中に示されている吸収スペクトルの変化と酷似しており、さらに、成膜時に金属アルミニ ウムを混入しているにもかかわらず、透明性が増してることからも、上記の熱還元反応と 、 引 き 続 い て 起 こ っ て い る 酸 化 還 元 反 応 に よ る 電 荷 移 動 錯 体 の 形 成 を し め す こ と が 分 か る

【実施例6】

[0087]

実施例6は、本発明の有機素子を無反射膜へ適用した例である。 着色顔料であって、かつ、ホール輸送能力を有することが知られている、 【化11】

の銅フタロシアニン(以下、CuPcと略記することがある)やキナクリドン顔料は、それぞれ赤色領域、青色領域の可視領域に強い吸収を持つため、本発明の「ホール電流 — 電子電流変換層」を用いて無反射層を形成して、高いコントラスト比を有する有機EL素子を作成することが出来る。

[0088]

図18に示すように、ガラス基板60上にITO層61、αNPD層62、赤色発光層63(DCJTB:Ala)の順に形成した有機EL素子構造の上に、Ala:Lia(30 1:1)からなる層64、Alからなる層65、 V,O。: С u P c からなる層66を順に積層してなる本発明の「ホール電流 – 電子電流変換層」を形成し、さらにその上にC u P c の層67を積層する。また、このC u P c の層67の上に、C u P c : V,O。の層68及びAlの層(陰極)69を形成して

ITO/αNPD/DCJTB: Alq/Alq: Liq(1:1) (50Å) /A] (15Å) /V,O,: CuPc/CuPc/V,O,: CuPc/Al (図18) の構造の素子260を生成する。

[0089]

ここで(DCJTB:Ala)の発光層 63で発生した赤色光のうち、陰極 69である A l 方向に進行する光は(CuPc/V $_1$ О $_3$:CuPc)の膜厚を調整して吸収させるこ 40 とが出来るので、コントラスト比の高い素子 260を作成することが出来る。

[0090]

また、「第39回応用物理学関係連合講演会講演予稿集、28p-Q-9, p. 1036 (1992)」に記載されているキナクリドン顔料とその誘導体や、特開2000-58 267号公報に記載されているインダンスレン顔料等、ホール輸送性を有して、かつ、特 有の波長域に光吸収能を有する場合は、本発明の構造を利用して、単独、もしくは積層や 混合の方法で、適宜、光反射陰極に接するホール電流層として利用出来る。

[0091]

このような顔料タイプの有機分子はホール輸送性である場合がほとんどなので、通常の有機EL素子の様に陰極に接する層に電子輸送性物質が必須である場合は、(言うまでもな 50

いが)このような顔料タイプのホール輸送性有機物を使用出来ない。

【実施例7】

[0092]

実施例7は、本発明の有機素子を高エネルギー成膜時のダメージ低減層へ適用した例である。

有機EL素子の陰極形成法として電子ビーム蒸着やスパッタリング蒸着等の高エネルギー粒子堆積法を用いるアイディアが知られている。本発明者は、前出の金属ドーピング層を電子注入層として用いれば、高仕事関数を有するITOでも容易に電子注入出来ることを、特開2002-332567号公報(特願2001-142672号明細書)に記載した。この時用いられたスパッタリング装置は有機膜に損傷のない工夫が施されているが 10、厳密には依然、若干のダメージが観測されていた。

[0093]

また、特開2000-58265号公報や特開2000-68063号公報には発光層上に銅フタロシアニン(CuPc)層をスパッタバッファー層として形成するアイディアが記されている。そこではLi等のアルカリ金属を、薄く形成されたCuPc上に蒸着すると、該Li金属はCuPc層中に拡散して発光層方向に横切ることが記されており、この場合は、結果的に、CuPcは(ホール輸送性分子としてではなく)電子輸送性分子としても作用できることが開示されている。

[0094]

しかし、本来 C u P c はホール輸送性分子であり、このように電子輸送層として使用する 20 方法には素子の劣化を早める要因となる懸念が生じる。

[0095]

一方、本発明の「ホール電流 - 電子電流変換層」を用いれば、スパッタ等の高エネルギー粒子堆積時のパッファー層としてのCuPcは従来通り、(本来の性質である)ホール輸送層として機能させることが出来る。例えば、ガラス基板70上に、ITOの層71、αNPDの層72、Alaの層73、Ala:Lia(1:1)の層74、Al層75、V,O;:CuPcの層76、CuPcの層77及びAl、ITOまたはその他の材料からなる陰極78を積層して

ITO/αNPD/Alq/Alq:Liq(1:1)(50Å)/Al(15Å)/V,O,:CuPc/CuPc/陰極(Al, ITO, etc) (図19)の構造の素子270を生成できる。

また、図19に示す上記素子の層77の上に、 V,O、: CuPcの層79を形成してITO/αNPD/Alq/Alq:Liq(1:1)、50Å/Al、15Å/V,O、: CuPc/CuPc/V,O、: CuPc/陰極(Al, ITO, etc) (図20)の様な構造を有する素子271を生成できる。これらの素子270、271によって、本来のホール輸送層としての機能と高エネルギー粒子によるダメージ低減層としての機能を併せ持つことが出来る。

【実施例8】

[0096]

実施例8は、本発明の有機素子を有機太陽電池への適用例である。 40 有機太陽電池素子は有機EL素子と似た構造を有しており、特に二層型タイプは、(ホール輸送性分子/電子輸送性分子)の界面で、光によって電荷発生することが知られている

[0097]

例えば、

- 1) Appl. Phys. Lett., 48, 183 (1986)
- 2) Chemistry Letters, pp. 327-330 (1990)
- 3) Appl. Phys. Lett., 76, 2650 (2000)
- 4) Appl. Phys. Lett., 79, 126 (2001)
- 5) Appl. Phys. Lett., 80, 1667 (2002)

50 .

に記載されている、典型的な構造が知られている。

[0098]

特に、上記の、2) や5)の文献では、従来の有機太陽電池の両電極に挟まれた部分(電荷発生ユニット)が複数個、直列に接続された構造が記載されており、例えば、5)の文献中では、

ITO/CuPc/PTCBI/Ag/CuPc/PTCBI/Ag

という、極薄(5 Å) のAg(銀) を使用して、電荷発生ユニット(CuPc/PTCBI)を 2 個直列に連結する構造がしめされている。

[0099]

この極薄のAgの代わりに、本発明の「ホール電流一電子電流変換層」を使用することが 10 出来る。つまり、例えば

ITO/CuPc/PTCBI/PTCBI: Rb (DPM): Alの共蒸着層/V,O,: CuPcの共蒸着層/CuPc/PTCBI/Ag

という構造によって、透明性が高く、かつ純粋な有機膜と比べても低抵抗化した膜であって、かつ、2個の電荷発生ユニットを、あたかも直列に接続できて、開放端電圧を略2倍とすることが出来る。上記の「PTCBI:Rb(DPM):Alの共蒸着層/V,O,:CuPcの共蒸着層」が本発明の「ホール電流ー電子電流変換層」として作用する。

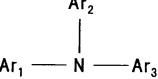
[0100]

そのほか、

ITO/((アリールアミン化合物等の)電子供与性(ホール輸送性)有機物):(V, 2O, や、4F-TCNQ等)/CuPc/PTCBI/((電子受容性(輸送性)有機物:低仕事関数金属のイオン含有化合物:熱還元性金属)の反応生成層)/((アリールアミン化合物等の)電子供与性(ホール輸送性)有機物):(V,O, や、4F-TCNQ等)の共蒸着膜/CuPc/PTCBI/((電子受容性(輸送性)有機物:低仕事関数金属のイオン含有化合物:熱還元性金属)の反応生成層)/金属の様に、従来から知られている、「電荷発生ユニット」の構成をそのまま使用して、該「電荷発生ユニット」を複数個、直列に接続できる。ここで、アミールアミンは、

【化1】

Ar₂



で示される。

[0101]

「電荷発生ユニット」の構成自体は、本発明の要素ではなく、既知のものや、新規に発見された好適な構成であれば、適宜用いることが出来る。なお、例えば、特開2003-24064085号公報には、本発明と類似の構造で、上記文献1)に記載されている「電荷発生ユニット」の構成を用いて、

ITO/CuPc/PV/CuPc:PVの共蒸着膜/CuPc/PV/Au という構造が、開示されており、このような構造でも、あたかも、開放端電圧を2倍にすることが可能であるかのように記載されているが、本発明者の検討では、2倍はおろか、「電荷発生ユニット」が1個の素子よりも発生電圧が低下することが明らかになった。

[0102]

これは、同一の物質の組み合わせを使用しても、積層膜構造(CuPc/PV)と混合膜構造(CuPc:PVの共蒸着膜)の相違の様な、態様の相違によって、「光電荷の発生機能」や「(電荷移動錯体の形成による)導電性の発現」という互いに別事象の機能が起 50

30

こりうる、という「間違った期待」から記載されている。しかし、実際には、本発明の「ホール電流 - 電子電流変換層」のような機能がなければ、期待される機能を得ることは出来ない。

【実施例9】

[0103]

実施例9は、本発明の有機素子を有機ELトランジスタへ適用した例である。

SIT (Static Induction Transistor) と呼ばれている、縦型FET (Field Effect Transistor) 構造を有する有機ELトランジスタが知られている。(第47回応用物理学関係連合講演会 講演予稿集30a-H-2, p. 1297、第63回応用物理学関係連合講演会 講演予稿集29p-ZH-15, p. 1161)

[0104]

このような有機 E L トランジスタの例として、図21に示すような素子320があり、基板90上に、順に、透明電極(ソース)91、ホール注入層92、ホール輸送層93、発光層94、陰極(ドレイン)95を形成してなる有機 E L 素子のホール輸送層93部分にスリット状のゲート電極(G)96が埋め込まれた形状を有しており、ゲート電極に印加される可変電圧値によって、発光閾値電圧や、発光強度を制御できる。しかし、(図21に示される通り)この構造によると、光の進行が妨げられたり、該ゲート電極のスリット間隔を自由に最適化することが難しくなる。

[0105]

これに対して、本発明の「ホール電流ー電子電流変換層」を用いることで、従来の有機 E L トランジスタ構造では実現できなかった構造も実現可能となる。例えば陰極 9 5 に接する層として、ホール輸送層 9 7 を配置することが出来る(図 2 2)。このとき、陰極 9 5 とホール輸送層 9 7 との間には、例えば V · O · (電子受容性化合物)と N P B (電子供与性有機物)からなるホール輸送部 9 8 を生成することができ、発光層 9 4 とホール輸送層 9 7 との間に本発明のホール電流ー電子電流変換層 1 2 0 を形成するホール輸送 8 9 9 と電子輸送部 1 0 0 を生成することができる。このような構成の有機 E L トランジスタ 2 9 0 においては、該ホール輸送層 9 7 部分にスリット状ゲート電極 9 6 を埋め込んで、従来の有機 E L 素子部分の構造を変えることなく、トランジスタ特性を付与出来る。

[0106]

また、例えば、陽極91に接する層として、電子輸送層121を配置することが出来る(図23)。このとき、陽極91と電子輸送層121との間には、電子輸送部122を生成することができ、電子輸送層121とホール輸送層93との間に本発明のホール電流一電子電流変換層120を形成するホール輸送部99と電子輸送部100を生成することができる。また、透明陰極95と発光層94との間には電子注入層123を生成してある。このような構成の有機ELトランジスタ291においては、該電子輸送層121にスリット状ゲート電極96を埋め込んで、従来の有機EL素子部分の構造を変えることなく、トランジスタ特性を付与出来る。もちろん、陰極に接する層として、ホール輸送層を配置して、かつ、陽極に接する層として、電子輸送層を配置して、該ホール輸送層と該電子輸送層の両方にゲート電極を埋め込んで、従来、実現不可能であった特性を付与する構造も作成の両方にゲート電極を埋め込んで、従来、実現不可能であった特性を付与する構造も作成の間にである。

[0107]

本発明について上記実施形態を参照しつつ説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、改良の目的または本発明の思想の範囲内において改良または変更が可能である。

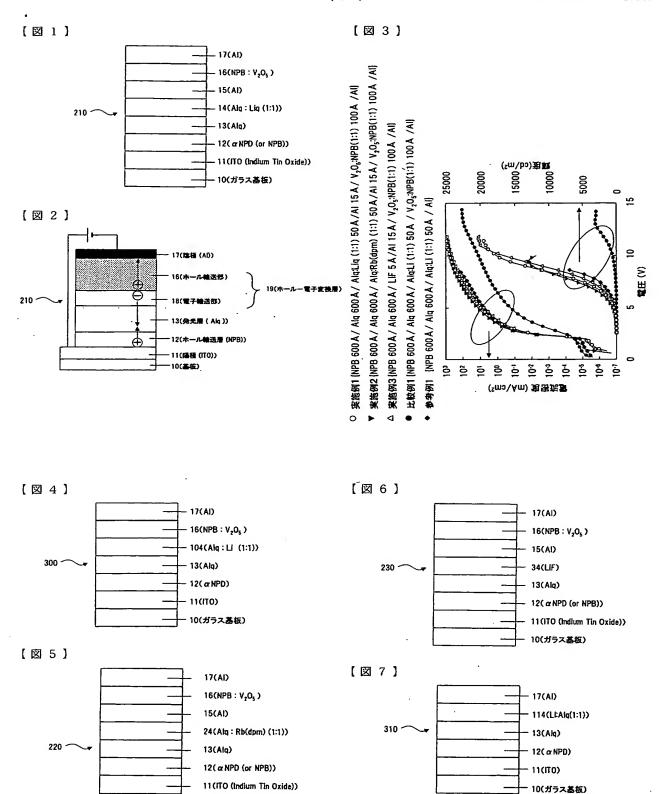
【図面の簡単な説明】

[0108]

- 【図1】本発明の実施例1に係る有機EL素子の構造を示す図である。
- 【図2】本発明の実施例1に係る有機EL素子の動作概念を示す図である。
- 【図3】実施例1~3、比較例1及び参考例1に係る素子の電圧 (V) 電流密度 (m A 50

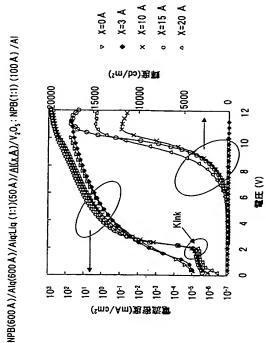
30

- / c m²) 輝度 (c d / m²) 特性を示す図である。
- 【図4】比較例1に係る有機EL素子の構造を示す図である。
- 【図5】本発明の実施例2に係る有機EL素子の構造を示す図である。
- 【図6】本発明の実施例3に係る有機EL素子の構造を示す図である。
- 【図7】参考例1に係る有機EL素子の構造を示す図である。
- 【図8】本発明の実施例1の構造を基準にして、アルミニウムの層の膜厚X(Å)を変化させたときの電圧(V) -電流密度(m A / c m¹) -輝度(c d / m¹)特性を示す図である。
- 【図9】本発明の実施例1の構造を基準にして、アルミニウムの層の膜厚X(Å)を変化させたときの電流密度(mA/cm²)-電流効率(cd/A)特性を示す図である。
- 【図10】本発明の実施例5に係る有機EL素子の構造を示す図である。
- 【図 1 1 】 本発明の実施例 5 に対する比較用素子に係る有機 E L 素子の構造を示す図である。
- 【図12】本発明の実施例5に対する比較用素子に係る有機EL素子の構造を示す図である。
- 【図13】吸光度測定用素子の構造を示す図である。
- 【図14】吸光度測定用素子に対する比較用素子の構造を示す図である。
- 【図 1 5 】 本発明の実施例 5 に係る素子及び比較用素子の電場 (V / c m) 電流密度 (A / c m ') 特性を示す図である。
- 【図16】吸光度測定用素子と比較用素子の波長(nm) 透過率(%)特性を示す図で 20 ある。
- 【図17】吸光度測定用素子と比較用素子の波長(nm)-吸光度特性を示す図である。
- 【図18】本発明の実施例6に係る素子の構造を示す図である。
- 【図19】本発明の実施例7に係る素子の構造を示す図である。
- 【図20】本発明の実施例7に係る素子の構造を示す図である。
- 【図21】従来のFET構造を有する有機EL素子の構造を示す図である。
- 【 図 2 2 】 本 発 明 の 実 施 例 9 に 係 る F E T 構 造 を 有 す る 有 機 E L 素 子 の 構 造 を 示 す 図 で あ る 。
- 【図23】本発明の実施例9に係るFET構造を有する有機EL素子の構造を示す図である。
- 【図24】従来の有機EL素子構造を電荷発生層を介して2段(n=1)、5段(n=4)、10段(n=9)、と重ねた場合に、電力変換効率(1m/W)が各輝度ごとにどのように変化するかをシミュレートした図である。
- 【図25】駆動電圧をV,+V,+ΔVとし、陰極や陽極からの注入障壁を無視した場合における発光ユニットを2個有するMPE有機EL素子のバンド図である。
- 【図26】駆動電圧をV,+V,とし、陰極や陽極からの注入障壁を無視した場合における発光ユニットを2個有するMPE有機EL素子のバンド図である。
- 【符号の説明】
- [0109]
- 10 基板
- 1 1 陽極
- 12 ホール輸送層
- 1 3 発光層
- 16 ホール輸送部
- 17 陰極
- 18 電子輸送部
- 19 ホール電流ー電子電流変換層



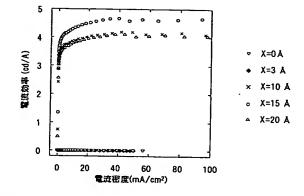
10(ガラス基板)



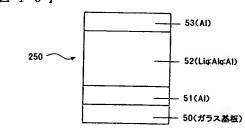


[図9]

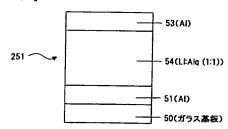
 $NPB(600\,\text{\AA})/Alq(600\,\text{Å})/AlqLiq~(1:1)(50\,\text{Å})/\underline{Al(x\,\text{Å})}/V_2O_5\colon NPB(1:1)~(100\,\text{Å})~/Al(x\,\text{Å})/V_2O_5$



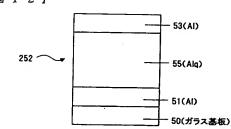
【図10】



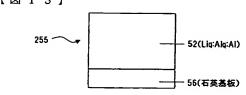
【図11】



【図12】



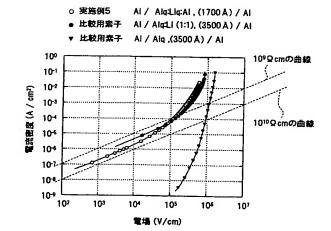
【図13】



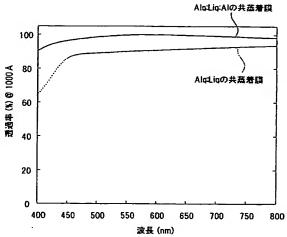
[図14]



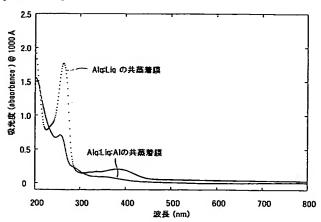
【図15】



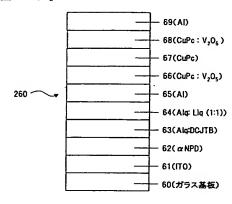




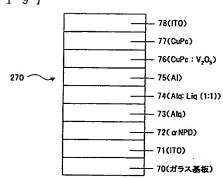
【図17】



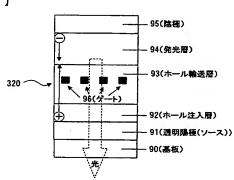
【図18】



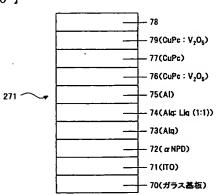
[図19]

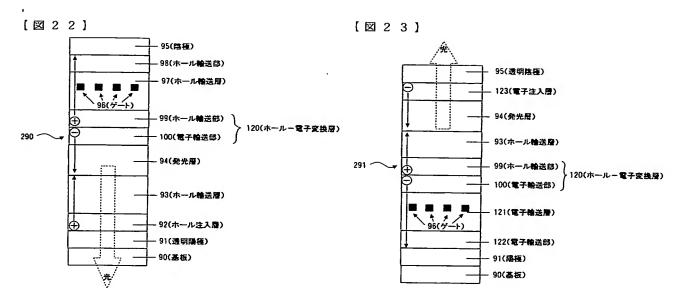


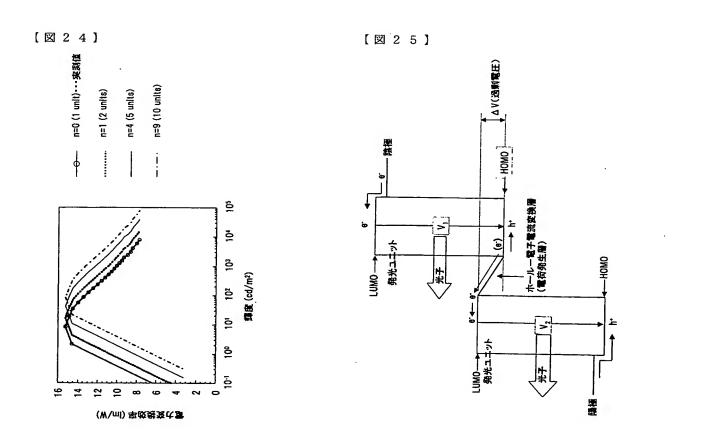
[図21]



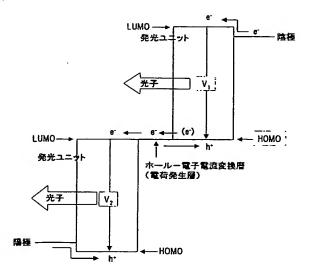
[図20]







【図26】



【手続補正書】

【提出日】平成16年10月25日(2004.10.25)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更・

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

仕事関数が4.0 e V以下の低仕事関数金属のイオンのうち少なくとも1種を含む有機金属錯体化合物と、前記有機金属錯体化合物中に含まれる金属イオンを真空中で金属状態に還元しうる熱還元性金属と、を積層もしくは共蒸着による混合により接触させて引き起こされたその場熱還元反応によって還元された低仕事関数金属と電子受容性有機物とが酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成して、前記電子受容性有機物がラジカルアニオン状態にある電子輸送部、及び

イオン化ポテンシャルが 5.7 e Vより小さく電子供与性を有する有機化合物と、前記有機化合物と酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成しうる無機物質又は有機物質と、が積層または混合されて接触しており、前記電子供与性を有する有機物がラジカルカチオン状態にあるホール輸送部、

が積層されてなるホール電流-電子電流変換層を含むことを特徴とする有機素子。

【請求項2】

仕事関数が4.0eV以下の低仕事関数金属のイオンのうち、少なくとも1種を含む無機化合物と、前記無機化合物中に含まれる金属イオンを真空中で金属状態に還元しうる熱還元性金属と、を積層もしくは共蒸着による混合により接触させて引き起こされたその場熱還元反応によって還元された低仕事関数金属と電子受容性有機物とが、酸化還元反応によ

って電荷移動錯体を形成して、前記電子受容性有機物がラジカルアニオン状態にある電子輸送部(熱還元反応生成部)、及び

イオン化ポテンシャルが 5.7 e V より小さく電子供 与性 を有する有機化合物と、前記有機化合物と酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成しうる無機物質又は有機物質とが、積層または混合されて接触しており、前記電子供与性を有する有機物がラジカルカチオン状態にあるホール輸送部、

が積層されてなるホール電流一電子電流変換層を含むことを特徴とする有機素子。

【請求項3】

電子輸送部と、ホール輸送部と、を積層してなるホール電流 - 電子電流変換層を含み、前記電子輸送部は、

仕事関数が4.0 e V以下の低仕事関数金属のイオンのうち少なくとも1種を含む有機金属錯体化合物と、

前記有機金属錯体化合物に対して積層もしくは共蒸着による混合により接触し、前記有機金属錯体中に含まれる金属イオンを真空中で金属状態に還元しうる熱還元性金属と、を有し、

前記接触により引き起こされたその場熱還元反応によって還元された低仕事関数金属と電子受容性有機物とが酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成して、前記電子受容性有機物がラジカルアニオン状態にあり、

前記ホール輸送層は、イオン化ポテンシャルが 5.7 e V より小さく電子供与性を有する有機化合物と、前記有機化合物に対して積層または混合されて接触し、前記有機化合物と酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成しうる無機物質又は有機物質と、を有し、前記電子供与性を有する有機物がラジカルカチオン状態にあることを特徴とする有機素子。

【請求項4】

電子輸送部と、ホール輸送部と、を積層してなるホール電流 - 電子電流変換層を含み、前記電子輸送部は、

仕事関数が4.0 e V以下の低仕事関数金属のイオンのうち少なくとも1種を含む無機化合物と、

前記無機化合物に対して積層もしくは共蒸着による混合により接触し、前記無機化合物中に含まれる金属イオンを真空中で金属状態に還元しうる熱還元性金属と、を有し、

前記接触により引き起こされたその場熱還元反応によって還元された低仕事関数金属と電子受容性有機物とが酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成して、前記電子受容性有機物がラジカルアニオン状態にあり、

前記ホール輸送層は、

イオン化ポテンシャルが5.7eVより小さく電子供与性を有する有機化合物と、

前記有機化合物に対して積層または混合されて接触し、前記有機化合物と酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成しうる無機物質又は有機物質と、を有し、

前記電子供与性を有する有機物がラジカルカチオン状態にあることを特徴とする有機素子

【請求項5】

請求項1または請求項3に記載の有機素子において、前記有機金属錯体化合物と前記電子受容性有機物が積層、または混合されて接触している有機素子。

【請求項6】

請求項2または請求項4に記載の有機素子において、前記無機化合物と前記電子受容性有機物が積層、または混合されて接触している有機素子。

【請求項7】

請求項1または請求項3に記載の有機素子において、前記有機金属錯体化合物中で金属イ オンに配位もしくは結合している有機分子部分が前記電子受容性有機物として機能する有機素子。

【請求項8】

請求項1または請求項3に記載の有機素子において前記有機金属錯体化合物と前記電子受

容性有機物が同一である有機素子。

【請求項9】

請求項1から8のいずれか1項に記載の有機素子において、前記熱還元性金属が、アルミニウム、ジルコニウム、シリコン、チタン及びタングステンから選択される少なくとも1種を含む有機素子。

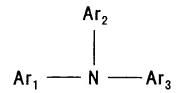
【請求項10】

請求項1から8のいずれか1項に記載の有機素子において、前記熱還元性金属が、マグネシウム、カルシウム、ストロンチウム、及びバリウムのアルカリ土類金属から選択される少なくとも1種を含み、かつ、前記有機金属錯体または前記無機化合物中に含有される4.0 e V以下の低仕事関数金属のイオンがアルカリ金属イオンである有機素子。

【請求項11】

請求項1から10のいずれか1項に記載の有機素子において、前記電子供与性を有する有機化合物がアリールアミン化合物であり、一般式(I):

【化1】



(式中、Ar,及びAr,は、それぞれ独立に置換基を有してよい芳香族炭化水素基を表わす。)

で示されるアリールアミン化合物である有機素子。

【請求項12】

請求項1から10のいずれか1項記載の有機素子において、前記電子供与性を有する有機化合物が顔料型有機物である有機素子。

【請求項13】

請求項12記載の有機素子において、前記電子供与性を有する有機化合物がポルフィリン化合物、または、その誘導体である有機素子。

【請求項14】

請求項12記載の有機素子において、前記電子供与性を有する有機化合物がキナクリドン化合物、またはその誘導体である有機素子。

【請求項15】

請求項12記載の有機素子において、前記電子供与性を有する有機化合物がインダンスレン化合物、またはその誘導体である有機素子。

【請求項16】

請求項11記載の有機素子において、前記電子供与性を有する有機化合物が、ガラス転移点が90℃以上であるアリールアミン化合物である有機素子。

【請求項17】

請求項1から4のいずれか1項記載の有機素子において、前記電子供与性を有する有機化合物と酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成しうる無機物質が金属酸化物である有機素子。

【請求項18】

請求項1から4のいずれか1項記載の有機素子において、前記電子供与性を有する有機化合物と酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成しうる無機物質が金属ハロゲン化物である有機素子。

【請求項19】

請求項16記載の有機素子において、前記金属酸化物が5酸化パナジウム、7酸化2レニウム、3酸化モリブデン、又は3酸化タングステンである有機素子。

【請求項20】

請求項1から4のいずれか1項記載の有機素子において、前記電子供与性を有する有機化合物と酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成しうる有機物質が少なくとも1個のフッ素を置換基として有する有機素子。

【請求項21】

請求項1から4のいずれか1項記載の有機素子において、前記電子供与性を有する有機化合物と酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成しうる有機物質が少なくとも1個のシアノ基を置換基として有する有機素子。

【請求項22】

請求項20または請求項21記載の有機素子において、前記電子供与性を有する有機化合物と酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成しうる有機物質が少なくとも1個のシアノ基と、少なくとも1個のフッ素を置換基として同時に有する有機素子。

[請求項23]

請求項22記載の有機素子において、前記電子供与性を有する有機化合物と酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成しうる有機物質がテトラフルオローテトラシアノキノジメタンである有機素子。

【請求項24】

請求項1から4のいずれか1項記載の有機素子において、前記電子供与性を有する有機化合物と酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成しうる有機物質が少なくとも1個のホウ素原子を有している有機素子。

【請求項25】

請求項1から4のいずれか1項記載の有機素子において、前記電子供与性を有する有機化合物と酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成しうる有機物質が少なくとも1個のホウ素原子と、少なくとも1個のフッ素を同時に有している有機素子。

【請求項26】

請求項25記載の有機素子において、前記電子供与性を有する有機化合物と酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成しうる有機物質が、トリスβー(ペンタフルオロナフチル)ボランである有機素子。

【請求項27】

請求項1から26のいずれか1項の有機素子において、有機EL素子を含む有機素子。

【請求項28】

請 求 項 1 か ら 2 6 の い ず れ か 1 項 の 有 機 素 子 に お い て 、 有 機 太 陽 電 池 を 含 む 有 機 素 子 。

【請求項29】

請求項1から26のいずれか1項の有機素子において、有機FET構造を含む有機素子。

【請求項30】

請求項1から26のいずれか1項の有機素子を含むことを特徴とする有機EL素子。

【請求項31】

請求項1から26のいずれか1項の有機素子を含むことを特徴とする有機太陽電池。

【請求項32】

請求項1から26のいずれか1項の有機素子を含むことを特徴とする有機FET構造。

【請求項33】

仕事関数が4.0eV以下の低仕事関数金属のイオンのうち少なくとも1種を含む有機金属錯体化合物と、前記有機金属錯体化合物中に含まれる金属イオンを真空中で金属状態に還元しうる熱還元性金属と、を積層もしくは共蒸着による混合により接触させてその場熱還元反応を起こし、前記その場熱還元反応によって選元された低仕事関数金属と電子受性有機物とを酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成して、前記電子受容性有機物がラジカルアニオン状態にある電子輸送部を形成する工程と、イオン化ポテンシャルが5.7eVより小さく電子供与性を有する有機化合物と、前記有機化合物と酸化還元反応により接触させて電荷移動錯体を形成しうる無機物質又は有機物質と、を積層または混合により接触させ、前記電子供与性を有する有機物がラジカルカチオン状態にあるホール輸送部を形成する工程と、

を備えることを特徴とする有機素子の製造方法。

【請求項34】

仕事関数が4.0 e V以下の低仕事関数金属のイオンのうち少なくとも1種を含む無機化合物と、前記無機化合物中に含まれる金属イオンを真空中で金属状態に還元しらる熱還元性金属と、を積層もしくは共蒸着による混合により接触させてその場熱還元反応を起こし、前記その場熱還元反応によって運元された低仕事関数金属と電子受容性有機物とをを設定元反応によって電荷移動錯体を形成して、前記電子受容性有機物がラジカルアニオン状態にある電子輸送部を形成する工程と、イオン化ポテンシャルが5.7 e Vより小さく電子供与性を有する有機化合物と、前記有機化合物と酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成しうる無機物質又は有機物質と、を積層または混合により接触させ、前記電子供を有する有機物がラジカルカチオン状態にあるホール輸送部を形成する工程と、を備えることを特徴とする有機素子の製造方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

[0001]

本発明は、有機エレクトロルミネッセント素子(以下、「有機EL素子」と略記することがある)、有機太陽電池、有機半導体(有機FET等)等、電荷輸送性有機物を使用する有機素子及びその製造方法に関する。

【背景技術】

[0002]

近年、有機半導体や有機導電体の研究が盛んに行われており、中でも有機半導体を使用する発光体である有機EL素子の進展がめざましい。

[0003]

有機EL素子において、Tangらは、素子の高効率化のため、キャリア輸送性の異なる有機化合物(ホール輸送性有機物と電子輸送性有機物)を積層し、ホールと電子がそれぞれ陽極、陰極よりバランスよく注入される構造とし、しかも該陰極と陽極に挟まれた有機層の層厚を2000A以下とすることで、10V以下の印加電圧で1000cd/m²と外部量子効率1%の実用化に十分な高輝度、高効率を得ることに成功した(App1.Phys.Lett.,51,913(1987)、特開昭59-194393号公報、特開昭63-264692号公報、特開平2-15595号公報、米国特許第4,539,507号明細書、同第4,769,292号明細書、同第4,885,211号明細書参照)。

[0004]

Tangらは、有機太陽電池においても、キャリア輸送性の異なる有機化合物(ホール輸送性有機物であるCuPcと電子輸送性有機物であるPV)を積層して、1%に近いパワー変換効率を実現している(Appl. Phys. Lett.、48,183(1986))。

[00005]

最近では、これら有機デパイスの電極に挟まれた部分を複数積層して、回路的には直列に接続することで、素子の高効率化を図るアイディアが論文、及び特許文献中に散見されるに至っている(Appl. Phys. Lett.、80,1667(2002)、Chemistry Letters, pp. 327-330(1990)、特開平11-329748号公報、米国特許第6337492号明細書、特開2003-45676号公報、特開2003-264085号公報、等参照)。

[0006]

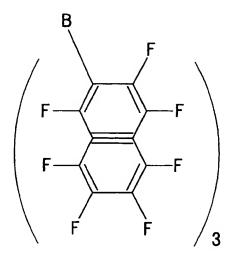
特に本発明者は特開 2 0 0 3 - 2 7 2 8 6 0 号公報において、 1 0 1 Ω c m 以上の比抵 抗を有する電気絶縁性の電荷発生層を用いて複数の有機EL発光ユニットを回路的に直列 に接続する手法を開示し、MPE (Multi-Photon Emission) 有機 EL素子と名付けて、学会、展示会等の機会を利用して発表、展示を行い高い評価を得て きた (第49回応用物理学会関係連合講演会、講演予稿集27p-YL-3, p. 130 8、第63回応用物理学会学術講演会、講演予稿集27a-ZL-12, p. 1165、 Proceedings of EL2002 (International Science and Technology ference on the Emissive Display and Lighting) p. 539, P roceedings of IDMC'03 (International play Manufacturing Conference) F r - 2 1 - 0 1p. 413, SID03 DIGEST, vol. XXXIV, BOOKII, . 964. SID 03 DIGEST, vol. XXXIV, BOOKII, 979、第13回フラットパネルディスプレオ製造技術展での講演会D-4(2003) 、LCD/PDP INTERNATIONAL2002での(株)アイメスの白色発光 体の展示及び配布資料、EExpress(2002年11月15日号)等参照)。 [0007]

この電荷発生層の構造は、本発明者がこれまで蓄積してきた有機EL素子の電極に接する電荷(電子やホール)注入層の組成を、順次、積層したものと類似している。具体的には、特開平10-270171号公報(米国特許第6013384号明細書)や特開2001-102175号公報(米国特許第6589673号明細書)で開示した、電子受容性(電子輸送性)有機物をアルカリ金属等の還元性(電子供与性)物質で還元して生成する該電子受容性有機物のラジカルアニオン分子を含有する層と、特開平11-251067号公報(米国特許第6423429号明細書)や特開2001-244079号公報(米国特許第6589673号明細書)や特開2003-272860号公報、特願2003-358402号、特願2004-202266号明細書等で開示した、電子供与性(ホール輸送性)有機物をV、O、やMoO、やWO、や、

[0008]

[化9]

で示される 4 F - T C N Q や、 【 0 0 0 9 】 【化10】



で示される PNB等の酸化性(電子受容性)物質で酸化して生成する該電子供与性有機物のラジカルカチオン分子を含有する層を順次積層した組成を有している(参照文献: K.L.T.Dao and J.Kido, J. Photopolym. Sci.Technol., 15, 261 (2002))(参照資料: IDW '04 Advance Program, p. 60, OLED2-4, Novel Mg: Alq, /WO, Connecting Layer for Tandem White Organic Light Emitting Diodes (WOLEDs)、C. -C. Chang, S. -W. Hwang, H. -H. Chen, C. H. Chen, J. -F. Chen (2004))。

この電荷発生層を介して従来型有機EL素子の陰極、陽極に挟まれた部分(発光ユニット)を積層すると、電圧印加時において、該電荷発生層から、陰極方向にホールが移動し、陽極方向に電子が移動するので、複数の発光ユニット中でホールと電子の再結合が生じ光子が発生する。結果として単位注入電流密度当たりの発光強度(例えば量子効率や電流効率)が略(n+1)倍になることが証明された(nは電荷発生層の層数)。

この場合、駆動電圧も略 (n+1) 倍となるので、原理的には、電力変換効率はほとんど 改善しない(変化しない)と予測された。

[0010]

しかしながら、厳密かつ詳細に検討すると、最適化された条件で作成されたMPE有機EL素子構造は、電力変換効率においても相応の改善効果を実現できる。有機半導体は無機半導体に比べ電荷移動度が桁違いに低いため、所望の電流値を得るには「付加的な電圧」を要することは周知である。ここで言う「付加的な電圧」とは、例えば、2eVの光子を放出するのに最低限必要な2Vのデバイス電圧を超えて、単位時間当たり、所望の、多量の光子を放出するために必要な電流密度を得るために「付加的に」必要とされる電圧(つまり、この場合は(駆動電圧-2V)=(付加的電圧))を言う。したがって、一般的に、輝度が電流密度のみに比例する有機EL素子を例にとれば、輝度の高い領域での電力変換効率は輝度の低い領域での電力変換効率よりも低下する(図24参照)。

しかしながら、MPE有機EL素子と従来の有機EL素子を同輝度において比較すれば、MPE素子の場合は所要電流密度が略 1 / (n+1)、 (nは電荷発生層の層数)となり、そのとき各(単位)発光ユニット当たり、消費される電位は、従来の有機EL素子で消費される電位よりも低下するので、実際には全消費電力は低下することになる(つまり電力変換効率は上昇する)。図24に従来の有機EL素子構造を電荷発生層を介して2段(n=1)、5段(n=4)、10段(n=9)、と重ねた場合に、電力変換効率(1 m/W)が各輝度ごとにどのように変化するかをシミュレートしたものを示した。ここでは電流効率(cd/A)がきっちり(n+1)倍となり、駆動電圧も、(同一輝度の時ではなく)同一電流密度の時に、きっちり(n+1)倍(nは電荷発生層の層数)となる場合を

示している。因みに従来構造の有機 E L 素子のデータ(1 段、 n = 0 の場合)は実際に作製した素子のデータである。

このような良好な状態のMPE素子は簡単に実現されるわけではない。例えば、所望の電流値を得るための電圧が従来構造の有機 E L 素子の(n+1)倍以上となる場合、つまり、発光ユニットを電荷発生層を介して重ねるたびに、望ましくない「過剰電圧(ΔV)」が加えられる事態が生じた場合は、当然のことながら電力変換効率も発光ユニットを重ねるたびに低下していくことになる。

[0011]

図25、図26に、発光ユニットを2個有するMPE有機EL素子のバンド図を示した。望ましくない「過剰電圧(ΔV)」は電荷発生層部分内部(本発明における「ホールー電子変換層」内部)で発生する。そもそも有機EL素子におけるホールの発生(または、注入)とは電子供与性分子(ホール輸送性分子)のHOMO(最高占有軌道)準位の電子が引き抜かれた状態の生成、つまりラジカルカチオン分子の生成と同義である。したがってMPE素子における電荷発生層の役割とは、電圧印加時に、該ラジカルアニオン分子の生成に伴って引き抜かれた電子を別の(陽極側の)発光ユニットの電子受容性分子(電子輸送性分子)のLUMO(最低非占有軌道)準位に注入することである。したがって可能の「過剰電圧(ΔV)」は、該HOMO準位の電子が該LUMO準位に移動する際に存在する(「ホールー電子変換層」内部の)「エネルギー障壁」によって発生するものである。この「HOMO準位の電子がLUMO準位に移動する」ことを別言すれば、「ホール電

したがって、(「ホールー電子変換層」内部の)該エネルギー障壁を限りなく 0 にすることで、(結果的に)「過剰電圧(Δ V)」を限りなく 0 にすることが出来たときに、前述の良好な状態の M P E 有機 E L 素子を初めて実現出来ることになる(図 2 6)。

[0012]

本発明者は鋭意検討の結果、該エネルギー障壁を限りなく0にして、理想的な「ホール電流一電子電流変換」を実現するに至った。具体的には、特開平11-233262号公報や特開2000-182774号公報(米国特許第6396209号明細書)(J.Endo,T.Matsumoto,and J.Kido,Jpn.J.Appl.Phys.Vol.41(2002)pp.L800-L803参照)で詳説されている手法を用いて、熱還元反応によって電子受容性有機物のラジカルアニオン分子が生成して存在している熱還元反応生成層と、特開平11-251067号公報や特開2001-244079号公報や特開2003-272860号等で詳説されている手法を用いて形成した層(遠藤ら、Jpn.J.Appl.Phys.Vol.41(2002)L358、第47回高分子学会予稿集、47巻9号、p1940(1998)、Leoら、Appl.Phys.Lett.、vol.78,No.4,(2001)参照)、つまり、酸化性分子によって、電子供与性有機物のラジカルカチオン分子が生成している層と、を順次電ねることによって、(HOMO準位を流れる)ホール電流が(LUMO準位を流れる)電子電流に障壁なく・変換、されることが判明した。

[0013]

しかしながら、本発明者らが開示した、特開平10-270171号公報(米国特許第6013384号明細書)、特開2001-102175号公報(米国特許第6589673号明細書)、人工、大はdoand、T. Matsumoto, Appl. Phys. Lett., 73、p. 2866(1998)、等で詳説されている手法、すなわち、アルカリ金属等の電子ドナー(還元性ドーパント)をドーピングすることで、電子受容性有機物のラジカルアニオン分子を生成した場合は、該電子ドナー(還元性ドーパント)と電子アクセプター(該酸化性分子)が直接に反応したり、前記電子受容性有機物と前記酸化性分子の間や、前記電子供与性分子(ホール輸送性分子)と前記電子ドナー(還元性ドーパント)の間にも、意図せずして、望ましくない反応が引き起こされ、結果として電子の移動を妨げることが懸念され、実際に本発明者の検討によれば該MPE有機EL素子の駆動電圧が段数(n+1)倍以上となってしまい、上記「過剰電圧(ΔV)」を0に出来

ないことが判明した。ここで、「駆動電圧が発光ユニットの重ね段数倍以上となってしま い..」というのは、同電流密度(または、同輝度)を達成するための駆動電圧が発光ユ ニットの重ね段数倍以上となることを意味し、特に高電流密度(または、高輝度)領域に なるにしたがってその傾向が顕著となる(つまりΔVの値には電流密度依存性がある)。 このような望ましくない状態のMPE有機EL素子の実施例は、本発明者らによる特開2 003-45676号公報や、特開2003-272860号公報に開示されている。 【特許文献 1】 特開昭 5 9 - 1 9 4 3 9 3 号公報 【特許文献2】特開昭63-264692号公報 【特許文献3】特開平2-15595号公報 【特許文献 4】 特開平 1 0 - 2 7 0 1 7 1 号公報 【特許文献 5】 特開平11-233262号公報 【特許文献 6】 特開平 1 1 - 2 5 1 0 6 7 号公報 【特許文献7】特開平11-329748号公報 【特許文献 8】 特開 2 0 0 0 - 1 8 2 7 7 4 号公報 【特許文献9】特開2001-102175号公報 【特許文献10】特開2001-244079号公報 [特許文献11]特開2003-45676号公報 【特許文献12】特開2003-264085号公報 【特許文献13】特開2003-272860号公報 【特許文献14】米国特許第4,539,507号明細書 【特許文献 1 5 】 米国特許第 4 , 7 6 9 , 2 9 2 号明細書 【特許文献16】米国特許第4,885,211号明細書 【特許文献 1 7】 米国特許第 6 、 3 3 7 、 4 9 2 号明細書 【非特許文献 1】 Appl. Phys. Lett., 51, 913 (1987) 【非特許文献 2】 Appl. Phys. Lett., 48, 183 (1986) 【非特許文献 3】 Chemistry Letters, pp. 327-330 (19 90) 【非特許文献 4】 J. Kido and T. Matsumoto, Appl. Phys . Lett., 73, p. 2866 (1998) 【非特許文献 5】 第 4 7 回高分子学会予稿集、 4 7 巻 9 号、 p 1 9 4 0 (1 9 9 8) 【非特許文献 6】 Leoら、Appl. Phys. Lett., vol. 78, No. 4 (2001)[非特許文献7] Appl. Phys. Lett., 80, 1667 (2002) 【非特許文献 8】 K. L. T. Dao and J. Kido, J. Photopo lym. Sci. Technol., 15, 261 (2002) 【非特許文献 9】 J. Endo, T. Matsumoto, and J. Kido, Jp n. J. Appl. Phys. Vol. 41 (2002) pp. L800-L803 【非特許文献10】遠藤ら、Jpn. J. Appl. Phys. Vol. 41 (2002) L 3 5 8 【非特許文献11】第49回応用物理学会関係連合講演会、講演予稿集27p-YL-3 , p. 1308 【非特許文献 1 2 】 第 6 3 回応用物理学会学術講演会、講演予稿集 2 7 a - Z L - 1 2, p. 1165 【非特許文献13】 Proceedings of EL2002 (Internat ional Conference on the Science and Tech nology of Emissive Display and Lighting) p. 539 【非特許文献 14】 Proceedings of IDMC'03 (Interna tional Display Manufacturing Conference)

Fr-21-01 p. 413, SID03 DIGEST, vol. XXXIV,

BOOKII, p. 964

【非特許文献 15】 SID 03 DIGEST, vol. XXXIV, BOOKII, p. 979

【非特許文献 16】 IDW '04 Advance Program, p. 60, OLE D2-4, Novel Mg: Alq3/WO3 Connecting Layer for Tandem White Organic Light Emitting Diodes (WOLEDs), C.-C. Chang, S.-W. Hwang, H.-H. Chen, C. H. Chen, J.-F. Chen (2004)

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0014]

本発明の目的は、下記に記載する電子輸送部としての層とホール輸送部としての層の2つの層を連続して積層させた「ホール電流 一電子電流変換層」(「ホールー電子変換層」)を、MPE有機EL素子の電荷発生層のみならず、従来型有機太陽電池を複数個、直列につなぐ「接続層」として用いたり、さらには一般的な有機素子の電極形成時のバッファー層として用いたりと、この層(が持つ利点)を一般化して広範囲に使用することで、従来型有機素子の持つ欠点を克服することにある。

【課題を解決するための手段】

[0015]

電子受容性有機物をラジカルアニオン分子とするために、(1)「アルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン、希土類金属イオン、及び一部の遷移金属イオンを代表とする、仕事関数が4.0eV以下の低仕事関数金属のイオンのうち、少なくとも1種を含む化合物(有機物でも無機物でもよい)」と、「(アルミニウムのように)該化合物に含まれる金属イオンを真空中(例えば蒸着チャンバー内の雰囲気)で金属状態に還元しうる熱還元性金属」とを、(真空蒸着による)積層、もしくは、共蒸着による混合により接触させて反応させ、該熱還元反応によって還元された低仕事関数金属と、その近傍に存在する電子受容性有機物とを(電子の授受による)酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成させて、該電子受容性有機物がラジカルアニオン状態にある電子輸送部(熱還元反応生成部)と

(2) (a) イオン化ポテンシャルが 5. 7 e V より小さく、電子供与性すなわちホール 輸送性を有する有機化合物と、(b) (a) の有機化合物と、(電子の授受による)酸化 還元反応によって電荷移動錯体を形成しうる無機物質又は有機物質とが、積層、または混 合されて接触しており、(a) の電子供与性有機物がラジカルカチオン状態にあるホール 輸送部、とが積層されてなる「ホール電流 – 電子電流変換層」 (「ホール – 電子変換層」)を有していればよく、この層の使用法は特に限定されない。

[0016]

本発明の有機素子は、仕事関数が4.0eV以下の低仕事関数金属のイオンのうち少なくとも1種を含む有機金属錯体化合物と、有機金属錯体化合物中に含まれる金属イオンを真空中で金属状態に還元しうる熱還元性金属と、を積層もしくは共蒸着による混合により接触させて引き起こされたその場熱還元反応によって選元された低仕事関数金属と電子受容性有機物とが酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成して、電子受容性有機物がラジカルアニオン状態にある電子輸送部、及び、イオン化ポテンシャルが5.7eVより小さく電子供与性を有する有機化合物と、有機化合物と酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成しうる無機物質又は有機物質と、が積層または混合されて接触しており、電子供を有する有機物がラジカルカチオン状態にあるホール輸送部、が積層されてなるホール電流ー電子電流変換層を含むことを特徴としている。

[0017]

本発明の有機素子は、仕事関数が4.0 e V以下の低仕事関数金属のイオンのうち、少なくとも1種を含む無機化合物と、無機化合物中に含まれる金属イオンを真空中で金属状態に還元しうる熱還元性金属と、を積層もしくは共蒸着による混合により接触させて引き

起こされたその場熱還元反応によって還元された低仕事関数金属と電子受容性有機物とが酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成して、電子受容性有機物がラジカルアニオン状態にある電子輸送部(熱還元反応生成部)、及び、イオン化ポテンシャルが5.7eVより小さく電子供与性を有する有機化合物と、有機化合物と酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成しうる無機物質又は有機物質とが、積層または混合されて接触しており、電子供与性を有する有機物がラジカルカチオン状態にあるホール輸送部、が積層されてなるホール電流一電子電流変換層を含むことを特徴としている。

[0018]

本発明の有機素子は、電子輸送部と、ホール輸送部と、を積層してなるホール電流・電子電流変換層を含み、電子輸送部は、仕事関数が4.0eV以下の低仕事関数金属のイオンのうち少なくとも1種を含む有機金属錯体化合物と、有機金属錯体化合物に対して積層もしくは共蒸着による混合により接触し、有機金属錯体中に含まれる金属イオンを場合で金属状態に還元しうる熱還元性金属と、を有し、接触により引き起こされたその場熱還元反応によって還元された低仕事関数金属と電子受容性有機物とが酸化還元反応によい動造にある有機物がラジカルフニオン状態にある有機化合物に対して積層または混合されて接触し、有機化合物と酸化還元反応による有機物がラジカルカチオン状態にあることを特徴としている。

[0019]

本発明の有機素子は、電子輸送部と、ホール輸送部と、を積層してなるホール電流・電子電流変換層を含み、電子輸送部は、仕事関数が4.0eV以下の低仕事関数金属のイオンのうち少なくとも1種を含む無機化合物と、無機化合物に対して積層もしくは共蒸元による混合により接触し、無機化合物中に含まれる金属イオンを真空中で金属状態に還元元を改造元性金属と、を有し、接触により引き起こされたその場へで電荷移動錯体を形成して、電子受容性有機物がラジカルアニオン状態にあり、ホール輸送層は、イオン化ポテンヤルが5.7eVより小さく電子供与性を有する有機化合物と、有機化合物に対して積層または混合されて接触し、有機化合物と酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成ける無機物質又は有機物質と、を有し、電子供与性を有する有機物がラジカルカチオン状態にあることを特徴としている。

[0020]

上記有機金属錯体化合物と電子受容性有機物は積層または混合されて接触していることが好ましい。

[0021]

上記無機化合物と電子受容性有機物も積層または混合されて接触していることが好ましい。

[0022]

上記有機金属錯体化合物中で金属イオンに配位もしくは結合している有機分子部分(部位)は電子受容性有機物として機能していても良い。

100231

上記有機金属錯体化合物と電子受容性有機物は、同一であっても良い。

[0024]

上記熱還元性金属は、アルミニウム、ジルコニウム、シリコン、チタン及びタングステンから選択される少なくとも 1 種を含むことが望ましい。

[0025]

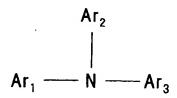
上記金属錯体化合物または上記無機化合物に含まれる低仕事関数金属のイオンがアルカリ金属イオンである場合は、上記熱選元性金属は、マグネシウム、カルシウム、ストロンチウム、及びバリウムのアルカリ土類金属から選択される少なくとも 1 種を含む金属であっても良い。

[0026]

上記電子供与性有機化合物は、アリールアミン化合物であり、一般式(I):

[0027]

【化1】



(式中、Ar」、Ar,及びAr,は、それぞれ独立に置換基を有してよい芳香族炭化水素基を表わす。)で示されるアリールアミン化合物であるとよい。

[0028]

上記電子供与性有機化合物は顔料型有機物であることが好ましい。

[0029]

上記電子供与性有機化合物は、ポルフィリン化合物またはその誘導体であるとよい。

[0030]

上記電子供与性有機化合物は、キナクリドン化合物またはその誘導体であることが好ましい。

[0031]

上記電子供与性有機化合物は、インダンスレン化合物またはその誘導体であることが好ましい。

[0032]

上記電子供与性有機化合物は、ガラス転移点が90℃以上であるアリールアミン化合物であるとよい。

[0033]

上記、電子供与性を有する有機化合物と酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成しうる無機物質は、金属酸化物であることが好ましい。

[0034]

上記、電子供与性を有する有機化合物と酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成しうる無機物質は、金属ハロゲン化物であることが好ましい。

[0035]

上記、電子供与性を有する有機化合物と酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成しうる金属酸化物は、V,O,(5酸化パナジウム)、7酸化2レニウム、MoO,(3酸化モリブデン)、又はWO,(3酸化タングステン)であることが好ましい。

[0036]

上記電子供与性を有す、る有機化合物と酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成しうる金属ハロゲン化物は、塩化第2鉄、臭化第2鉄、等の鉄ハロゲン化物や、アルミニウムハロゲン化物、ガリウムハロゲン化物、インジウムハロゲン化物、アンチモンハロゲン化物、又は、ヒ素ハロゲン化物から適宜選択されることが好ましい。

[0037]

上記、電子供与性を有する有機化合物と酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成しうる有機物質は、少なくとも1個のフッ素を置換基として有するとよい。

[0038]

上記、電子供与性を有する有機化合物と酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成しうる有機物質は、少なくとも1個のシアノ基を置換基として有することが好ましい。

[0039]

上記、電子供与性を有する有機化合物と酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成しうる有機物質は、少なくとも1個のシアノ基と、少なくとも1個のフッ素を置換基として同時に有することが好ましい。

[0040]

上記、電子供与性を有する有機化合物と酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成しうる有機物質は、テトラフルオローテトラシアノキノジメタンであることが好ましい。

[0041]

上記、電子供与性を有する有機化合物と酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成しうる有機物質は、少なくとも1個のホウ素原子を有していることが好ましい。

[0042]

上記、電子供与性を有する有機化合物と酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成しうる有機物質は、少なくとも1個のホウ素原子と、少なくとも1個のフッ素を同時に有しているとよい。

[0043]

上記、電子供与性を有する有機化合物と酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成しうる有機物質は、トリスβ- (ペンタフルオロナフチル) ポランであるであることが好ましい。

[0044]

本発明の有機素子は、有機EL素子を含むことを特徴としている。

[0045]

本発明の有機素子は、有機太陽電池を含むことを特徴としている。

[0046]

本発明の有機素子は、有機FET構造を含むことを特徴としている。

[0047]

本発明の有機EL素子は、上記有機素子を含むことを特徴としている。

[0048]

本発明の有機太陽電池は、上記有機素子を含むことを特徴としている。

[0049]

本発明の有機FET構造は、上記有機素子を含むことを特徴としている。

[0050]

本発明の有機素子の製造方法は、仕事関数が4.0eV以下の低仕事関数金属のイオンのうち少なくとも1種を含む有機金属錯体化合物と、有機金属錯体化合物中に含まれる金属イオンを真空中で金属状態に還元しうる熱還元性金属と、を積層もしくは共蒸着による混合により接触させてその場熱還元反応を起こし、その場還元反応によって還元された低仕事関数金属と電子受容性有機物とを酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成して、電子受容性有機物がラジカルアニオン状態にある電子輸送部を形成する工程と、イオン化ポテンシャルが5.7eVより小さく電子供与性を有する有機化合物と、有機化合物と酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成しうる無機物質又は有機物質と、を積層または混合により接触させ、電子供与性を有する有機物がラジカルカチオン状態にあるホール輸送部を形成する工程と、を備えることを特徴としている。

本発明の有機素子の製造方法は、仕事関数が4.0eV以下の低仕事関数金属のイオンのうち少なくとも1種を含む無機化合物と、無機化合物中に含まれる金属イオンを真空中で金属状態に還元しうる熱還元性金属と、を積層もしくは共蒸着による混合により接触させてその場熱還元反応を起こし、その場還元反応によって電荷移動錯体を形成して、電子受容性有機物がラジカルアニオン状態にある電子輸送部を形成する工程と、イオン化ポテンシャルが5.7eVより小さく電子供与性を有する有機化合物と、有機化合物と酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成しうる無機物質又は有機物質と、を積層または混合により接触させ、電子供与性を有する有機物がラジカルカチオン状態にあるホール輸送部を形成する工程と、を備えることを特徴としている。

【発明の効果】

[0051]

電子輸送部としての層とホール輸送部としての層を連続して積層させた「ホール電流-電

子電流変換層」(「ホールー電子変換層」)を、MPE有機EL素子の電荷発生層のみならず、従来型有機太陽電池を複数個、直列につなぐ「接続層」として用いたり、さらには一般的な有機素子の電極形成時のバッファー層として用いたりと、この層(が持つ利点)を一般化して広範囲に使用することで、従来型有機素子の持つ欠点を克服することができる。

[0052]

熱還元反応生成層(電子輸送部)中では、アルミニウムやマグネシウム等の熱還元性金属はすでに金属原子として存在しておらず、イオン状態(酸化状態)として存在しているため、下記の実施例に見られるように良好な透明性を付与することができる。

アルカリ金属を代表とする還元性ドーパントは大気中で発火するほど反応活性なものがほとんどなので、本発明の手法はそのような金属のハンドリングが不要になる、という工程上の優位点がある。

透明性が高く、かつ、発明者らが特開平10-270171号公報や特開2001-102175号公報等で開示した、還元性ドーパントがドーピングされた電子輸送層と略同等の比抵抗を有する膜を得ることが可能である。

【発明を実施するための最良の形態】

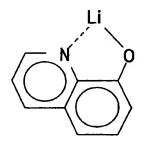
[0053]

<第1実施形態>

第1 実施形態においては、電子輸送部(熱還元反応生成部)の構成物質として、アルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン、希土類金属イオン及び一部の遷移金属イオンを代表とする仕事関数が4.0 e V以下の低仕事関数金属(アルカリ金属)のイオン含有有機物として、

[0054]

【化2】

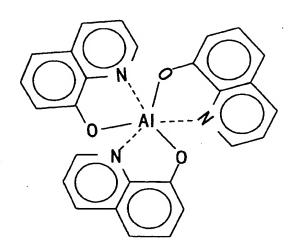


で示される、(8 - キノリノラト)リチウム錯体 (以下、Li q と略記することがある)を使用し、

さらに、電子受容性(輸送性)有機物として、

[0055]

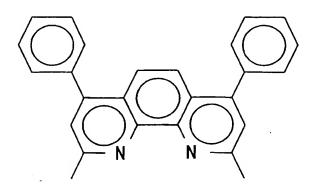
[化3]



で表されるトリス (8-キノリノラト) アルミニウム錯体 (以下、Alqと略記することがある)、もしくは

[0056]

[化4]



で示されるパソクプロイン(以下、BCPと略記することがある)の様な有機物を、あらかじめ共蒸着の手法により混合層として形成しておき、さらにその混合層上に代表的熱還元性金属であるアルミニウムを適量真空蒸着するのが好適な形成方法の一つである。この時、アルミニウム金属はアルカリ金属イオン(LiQではLi゚)を還元(その場(in-situ)還元反応)するので自らは、当然、酸化状態に変化する(アルミニウムイオン含有化合物となる)。さらに還元されて生成したLi金属は近傍に存在する電子受容性(電子輸送性)有機物(例えばAlQ)と電子の授受による酸化還元反応によって((Li+AlQ →)Li + AlQ (ラジカルアニオン))の電荷移動錯体を形成する。ここで、生成したラジカルアニオンが電子電流の担い手(内部電荷)として振る舞える分けである。

[0057]

このようにして生成した、熱還元反応生成層は(純粋な有機物と比べても)一般に、透明性が高く、さらに純粋な有機物と比べ比抵抗が低下する(つまり、導電性が上昇する)特徴がある。このような導電性の上昇は、該プロセスが「アルミニウムの様な金属を混入するプロセスであるから」、とする誤解を生ずることがあるが、上記のように、該熱還元反応生成層中では、既にアルミニウムは金属原子として存在しておらず、イオン状態(酸化状態)として存在している。したがって良好な透明性が付与される分けである。導電性の向上の要因は、上記Ala(ラジカルアニオン)の生成に起因している(実施例4,5参照)。

[0058]

アルミニウム等の熱還元性金属の量はアルカリ金属イオン含有化合物中のイオンを金属に還元するための「過不足のない量」が好ましく、この量が少ないと十分に該熱還元反応を起こすことが出来ずに、結果として電子受容性(輸送性)有機物がラジカルアニオンとなることが出来ないし、過剰であると該熱還元反応に寄与出来ない(つまり酸化状態に変化出来ない)金属アルミニウムが残存するため、膜の透明性を低下させるので所望の効果が期待出来なくなる。このような現象を示す例を下記実施例4に示した。

[0059]

<第2実施形態>

第2 実施形態においては、電子輸送部(熱還元反応生成部)の構成物質として、第1 実施形態と同様に低仕事関数金属(アルカリ金属)イオン含有化合物として、Ligの様なアルカリ金属イオン含有有機金属錯体と、Algの様な電子受容性(輸送性)有機物と、さらにアルミニウムのような熱還元性金属を同時に蒸着して混合させて(3 元共蒸着)、上記と同様の機能を持つ電子輸送部を作成することも可能である。この場合該3 つの物質の蒸着比率を適正に制御することで、透明性が高く、かつ本発明者が特開平10-2701 71号公報や特開2001-102175号公報等で開示した還元性ドーパントがドーピングされた電子輸送層と略同等の比抵抗を有する膜を得ることが可能である(実施例5参 照)。言うまでもなく、アルカリ金属を代表とする該還元性ドーパントは大気中で発火するほど反応活性なものがほとんどなので、本発明の手法はそのような金属のハンドリングが不要になる、という工程上の優位点がある。

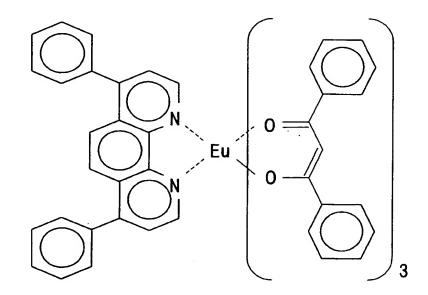
[0060]

<第3実施形態>

第3実施形態においては、電子輸送部(熱還元反応生成部)の構成物質として、

[0061]

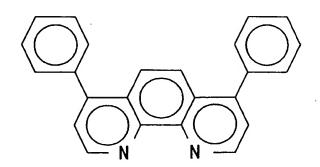
【化5】



で、示されるトリ(1、3-フェニル-1、3-プロパンジオナト)モノ(バソフェナントロリン)ユウロピウム錯体(以下、「Eu(DBM)3・BPEHEN」と略記することがある)の様な希土類金属イオン含有有機金属錯体であって、配位子の一つに

[0062]

【化6】



で示されるバソフェナントロリン(以下、BPHEN)の様な、それ自身に電子受容性(輸送性)を有する化合物を有している場合は、Eu(DBM)3・BPEHENの化合物と熱環元性金属であるアルミニウムを同時に蒸着して混合させ(2元共蒸着)、上記と同様の機能を持つ電子輸送部を作成することも可能である。この場合も、該2つの物質の蒸着比率を適正に制御することで、透明性が高く、かつ本発明者が特開平10-270171号公報や特開2001-102175号公報等で開示した、還元性ドーパントがドーピングされた電子輸送層と略同等の比抵抗を有する膜を得ることが可能である(Euの酸化によるBPHEN-(ラジカルアニオン)の生成)。

[0063]

<第4実施形態>

第4実施形態においては、上記Liqの様に、アルカリ金属イオンを含有して、かつ、それ自身が電子受容性(輸送性)を併せ持つ化合物である場合は、熱環元性金属であるアル

ミニウムと適当な比率で同時に蒸着して混合させ(2元共蒸着)、上記と同様の機能を持つ電子輸送部を作成することも可能である。この場合は、アルミニウムによって熱還元されないLi q が残存していることが想定されており、酸化還元反応によって(Li'+Li q '(ラジカルアニオン))の電荷移動錯体を形成する。もちろん、上記のアルカリ金属イオンや、希土類金属イオンのような低仕事関数金属のイオン含有化合物であれば、上記有機金属錯体に代えて無機化合物を使用してもよい。

[0064]

上記の実施形態 1 ~ 4 に示される電子輸送部に隣接して形成される本発明のホール輸送部は、既にこれまで有機 E L 素子のホール注入層やホール輸送層中で広く使用されている、イオン化ポテンシャルが 5 . 7 e V より小さく電子供与性を有する有機化合物と、前記有機化合物と酸化還元反応によって電荷移動錯体を形成しうる無機物質又は有機物質と、が積層または混合されて接触しており、前記電子供与性を有する有機化合物がラジカルカチオン状態にあるホール輸送部となっている。

[0065]

なお、有機化合物、金属、及び「ホール電流 - 電子電流変換層」の成膜には、日本ビーテック製真空蒸着機を使用した。蒸着物質の成膜速度の制御や膜厚の制御は該蒸着機に取付けられている、水晶振動子を使用した成膜モニターCRTM-8000(ULVAC(日本真空技術社)製)を使用した。また、成膜後の実質膜厚の測定には、テンコール(Tencor)社製P10触針式段差計を用いた。素子の特性評価には、ケースレー(KEITHLEY)社ソースメータ2400、トプコンBM-8輝度計を使用した。また、吸収スペクトルの測定は、パーキンエルマー製:ラムダ19を使用して測定した。

[0066]

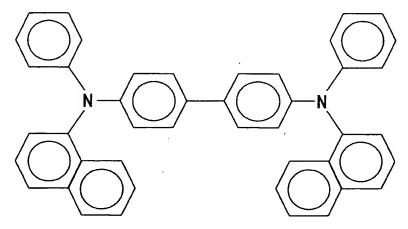
以下に実施例を挙げて本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はこれにより限定されるものではない。

【実施例1】

[0067]

実施例 1 は、陰極に接する層に、本発明の「ホール電流-電子電流変換層」を有しており、結果的に、ホール電流の流れる層が陰極に接している有機EL素子の例である。この例では、図 1 に示すように、ガラス基板 1 0 上にパターニングされた I T O (I n d i u m T i n O x i d e)陽極 1 1 上に、下記式

【化7】



で表わされる 4 、 4 、 - ピス [N - (2 - ナフチル) - N - フェニル - アミノ] ピフェニル (以下、αNPD、または、NPBとも略記することがある。) を 6 0 0 Å の厚さで真空蒸着によりホール輸送層 1 2 として積層し、ついで発光層 1 3 として、A 1 q を 6 0 0 Å の厚さで積層した。

[0068]

次に、上記AlqとLiq(低仕事関数金属イオン含有化合物)を、モル比率1:1で 50Åの厚さに成膜した(層14)。さらにその上から熱還元性金属であるアルミニウム を 1 5 Å (に相当する量) 蒸着した(層 1 5)。次に上記 α N P D α 5 酸化パナジウム(α 1 0 0 Å 0 厚さで成膜した(層 α 1 6)(ホール輸送部)。最後に陰極金属 α 7 としてアルミニウムを α 1 0 0 0 Å 0 厚さで成膜した。

この有機EL素子210の構造を簡便に表記すると、ITO/ α NPD(600Å)/A l q (6.00Å) /A l q : L i q (1 : 1) (50Å) /A l (15Å) / V_1O_5 : α NPD(1 : 1) (100Å) /A l (図1) となる。以下の説明ではこのような(簡便な)表記法を用いることとする。

この有機EL素子210において、陽極電極であるITOと陰極電極であるA1との間に、直流電圧を印加して、諸特性を測定した結果を図3に示す。図3の〇プロットは、この素子の電圧(V) - 電流密度(m A / c m²) - 輝度(c d / m²)特性を示す。また、この素子の動作概念を示した図2に示すように、層14及び層15は、電子輸送部(熱愛元反応生成層)18として、層16と層18はホール電流 - 電子電流変換層19として機能する。

<比較例1>

比較例1は、実施例1と比較するため、本発明の電子輸送部である熱還元反応生成層18 を用いない構造、すなわち、実施例1の層14のLiqに代えて金属Liを層104に使用した例であり、その素子300の構造は

ITO/ α NPD (600Å) /Alq (600Å) /Alq:Li (1:1) (50Å) /V,O;: α NPD (1:1) (100Å) /Al (\boxtimes 4)

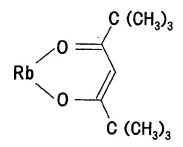
となっている。この有機EL素子300の諸特性を測定した結果を図3の●プロットで示す。

【実施例2】

[0069]

実施例2においては、実施例1の層14のLiqに代えて、

[化8]



で示される、モノ(2、2、6、6ーテトラメチルー3、5ーヘプタンジオナト)ルビジウム錯体(以下、Rb(dpm)と略記することがある)を層24に使用しており、ITO/ α NPD(600Å)/Alq(600Å)/Alq:Rb(dpm)(1:1)(50Å)/Al(15Å)/ V_1O_3 : α NPD(1:1)(100Å)/Al(図5)なる構造の素子220を作成した。この有機EL素子220の諸特性を測定した結果を図3の▼プロットで示す。

【実施例3】

[0070]

実施例3においては、実施例1の層14のLiqに代えてアルカリ金属の無機化合物であるLiF(フッ化リチウム)を層34に使用して、

ITO/αNPD (600Å)/Alq (600Å)/LiF (10Å)/Al (15Å)/V₁O₅: αNPD、(100Å)/Al (図6)

なる構造の素子230を作成した。この構造は電子受容性化合物であるAlq (層13)とアルカリ金属化合物のLiF (層34)が、(混合ではなく)積層されて接触している。この有機EL素子230の賭特性を測定した結果を図3の△プロットで示す。

く参考例1> (従来型の有機EL素子の例)

参考例1として、本発明の「ホール電流ー電子電流変換層」の構成を有していない、す

なわち実施例 1 の層 1 4 ~ 1 6 を有さない素子 3 1 0 を作成した。この素子は、実施例 1 の層 1 4 ~ 1 6 に代えて、Ala:Li(1:1)からなる層 1 1 4 を備えており、 ITO/αNPD (6 0 0 Å)/ Ala(6 0 0 Å)/ Ala:Li(1:1)(5 0 Å)/ A l

なる構造となっている(図7)。この有機EL素子の諸特性を測定した結果を図3の◆プロットで示す。

実施例1~3、比較例1、参考例1の結果を比較すると、本発明の「ホール電流 - 電子電流変換層」を有する有機 E L 素子は従来型の素子と比べても遜色なく機能し、むしろ、より低電圧で駆動出来ることが分かった。また、アルカリ金属のような還元性ドーパントを使用すると、ホール電流 - 電子電流変換層内部に、エネルギー障壁が生成してしまうため、同電流密度、または同輝度を達成するために必要な電圧が高くなることが示された。

【実施例4】

[0071]

実施例 4 として、熱還元性金属の役割を確認し、かつ、その最適蒸着量(もしくは最適膜厚)を確認する実験を行った。実施例 1 の構造を基準にして、熱還元性金属であるアルミニウムの蒸着量を変化させて、有機 E L 素子としての特性の変化を調べた。すなわち I T O / α N P D (6 0 0 Å) / A l q (6 0 0 Å) / A l q : L i q (1 : 1) (5 0 Å) / A l (X Å) / V₂O₃: α N P D (1: 1) (1 0 0 Å) / A l の構造で、A l の層 1 5 の膜厚 (X Å) を変化させた。

[0072]

図8、図9の▽プロットはX=0 (つまりアルミニウムを蒸着しない場合)のとき、◆プロットはx=3Åのとき、×プロットはX=10Åのとき、○プロットはX=15Åのとき、△プロットはX=20Åのときの各素子の、電圧 (V) -電流密度 (mA/cm²) -輝度 (cd/m²) 特性 (図8)、電流密度 (mA/cm²) -電流効率 (cd/A) (図9)を示す。

この結果から、熱還元性金属の蒸着量が所定量より少ないと、発光が観測されないことが示された(x=0Å,もしくは3Åの場合に対応)。これは、熱還元反応生成層内で電子受容性有機物のラジカルアニオン分子が生成されなかったため、発光層内に電子が注入されなかったためである。したがって、この時観測された電流はホール電流のみの電流である(2.2 V近辺に発光開始電圧を示唆する 'キンク(Kink)'が観測されないという事実からも、そのことが裏付けられる。)。

また、図8、図9のグラフに示される結果から、この実験の範囲内ではアルミニウムを15Åの膜厚に相当する量に制御すると、輝度や効率が最も高い値を示すことが分かった。 それ以上にアルミニウムの蒸着量を増やすと、熱還元反応に寄与しない(つまり酸化状態に変化出来ない)金属アルミニウムが残存して素子特性を低下させることが示された。

【実施例5】

[007.3]

実施例 5 は、低仕事関数金属のイオン含有化合物と、電子受容性有機物と、熱還元性金属を同時に蒸着(3元共蒸着)して「透明性」と「導電性」を付与させた例である。 A I がパターニングされたガラス基板 5 0 と、吸光度測定用の石英基板 5 6 をそれぞれ用意して、以下の手順で蒸着成膜を行った。

[0074]

まず、低仕事関数有機金属錯体であるLi q と、電子受容性有機物であるAl q と、熱還元性金属であるAl (アルミニウム)を、Al電極51上に、膜厚速度比で、(Li q :Al q:Al=1A/s(Li q):3A/s(Al q):0.3A/s(Al))となるように共蒸着して層52を形成し、さらにAl電極53を生成し、Al/Li q:Al q:Al/Al (図10)の構造の素子250を作成した。

[0075]

また、比較用素子として、上記層 5 2 に代えて、アルカリ金属としてLiを直接電子受容性有機物(Ala)と混合して層 5 4 を生成した、A1/Ala:Li(1:1、モル

比率) / A 1 (図 1 1) の構造の素子 2 5 1 を作成した。

[0076]

また、上記層 5 2 に代えて、A 1 q 単独膜 5 5 を電極 5 1 、 5 3 で挟んだ、A 1 / A 1 q / A 1 (図 1 2) の構造の素子 2 5 2 を作成して、それぞれ、電場 (V / c m) - 電流密度 (A / c m³) 特性を測定した (図 1 5)。

[0077]

[0078]

また、吸光度(及び、透過率)測定用素子として、石英基板 5 6 上にLia:Ala:Alを共蒸着して

石英基板/Liq:Alq:Al、(図13)

なる構造の素子255を作成した。この素子255は、石英基板56上に、膜厚速度比で、(Lia:Ala:Al=1A/s(Lia):3A/s(Ala):0.3A/s(Al))となるように共蒸着して層52を形成した。また、比較用素子256として、熱還元性金属であるAlを混入させずに、石英基板56上にLia:Ala(層57)を共蒸着して石英基板/Lia:Ala の素子を作成した。(図14)

【実施例6】

[0079]

実施例 6 は、本発明の有機素子を無反射膜へ適用した例である。、 着色顔料であって、かつ、ホール輸送能力を有することが知られている、 【化11】

の銅フタロシアニン(以下、 C u P c と略記することがある)やキナクリドン顔料は、それぞれ赤色領域、 青色領域の可視領域に強い吸収を持つため、 本発明の「ホール電流 - 電子電流変換層」を用いて無反射層を形成して、高いコントラスト比を有する有機 E L 素子を作成することが出来る。

[0800]

図 1 8 に示すように、ガラス基板 6 0 上に I T O 層 6 1 、 α N P D 層 6 2 、赤色発光層 6 3 (D C J T B : A 1 q) の順に形成した有機 E L 素子構造の上に、A 1 q : L i q (1 : 1) からなる層 6 4 、A 1 からなる層 6 5 、V · O 。: C u P c からなる層 6 6 を順に積層してなる本発明の「ホール電流ー電子電流変換層」を形成し、さらにその上に C u P c の層 6 7 を積層する。また、この C u P c の層 6 7 の上に、C u P c : V · O 。の層 6 8 及び A 1 の層 · (陰極) 6 9 を形成して I T O / α N P D / D C J T B : A 1 q / A 1 q : L i q (1 : 1) (5 0 Å) / A 1 (1 5 Å) / V · O 。: C u P c / C u P c / V · O。: C u P c / A 1 (2 : C u P c / A 1) の構造の素子 2 6 0 を生成する。

[0081]

ここで(DCJTB:Alq)の発光層63で発生した赤色光のうち、陰極69であるAl方向に進行する光は(CuPc/V,O,: CuPc)の膜厚を調整して吸収させることが出来るので、コントラスト比の高い素子260を作成することが出来る。

また、「第39回応用物理学関係連合講演会講演予稿集、28p-Q-9, p. 1036 (1992)」に記載されているキナクリドン顔料とその誘導体や、特開2000-58 267号公報に記載されているインダンスレン顔料等、ホール輸送性を有して、かつ、特 有の波長域に光吸収能を有する場合は、本発明の構造を利用して、単独、もしくは積層や 混合の方法で、適宜、光反射陰極に接するホール電流層として利用出来る。

このような顔料タイプの有機分子はホール輸送性である場合がほとんどなので、通常の有機 E L 素子の様に陰極に接する層に電子輸送性物質が必須である場合は、(言うまでもない)このような顔料タイプのホール輸送性有機物を使用出来ない。

【実施例7】

[0082]

実施例7は、本発明の有機素子を高エネルギー成膜時のダメージ低減層へ適用した例である。

[0083]

有機EL素子の陰極形成法として電子ビーム蒸着やスパッタリング蒸着等の高エネルギー粒子堆積法を用いるアイディアが知られている。本発明者は、前出の金属ドーピング層を電子注入層として用いれば、高仕事関数を有するITOでも容易に電子注入出来ることを、特開2002-332567号公報(特願2001-142672号明細書)に記載した。この時用いられたスパッタリング装置は有機膜に損傷のない工夫が施されているが、厳密には依然、若干のダメージが観測されていた。

また、特開 2 0 0 0 - 5 8 2 6 5 号公報や特開 2 0 0 0 - 6 8 0 6 3 号公報には発光層上に銅フタロシアニン(C u P c)層をスパッタパッファー層として形成するアイディアが記されている。そこではLi等のアルカリ金属を、薄く形成された C u P c 上に蒸着すると、該Li金属は C u P c 層中に拡散して発光層方向に横切ることが記されており、この場合は、結果的に、 C u P c は(ホール輸送性分子としてではなく)電子輸送性分子としても作用できることが開示されている。

しかし、本来CuPcはホール輸送性分子であり、このように電子輸送層として使用する方法には素子の劣化を早める要因となる懸念が生じる。

[0084]

一方、本発明の「ホール電流 - 電子電流変換層」を用いれば、スパッタ等の高エネルギー粒子堆積時のパッファー層としてのCuPcは従来通り、(本来の性質である)ホール輸送層として機能させることが出来る。例えば、ガラス基板70上に、ITOの層71、αNPDの層72、Alaの層73、Ala:Lia(1:1)の層74、Al層75、V.O、:CuPcの層76、CuPcの層77及びAl、ITOまたはその他の材料からなる陰極78を積層して

ITO/αNPD/Alq/Alq:Liq(1:1)(50Å)/Al(15Å)/V,O,:CuPc/险極(Al, ITO, etc) (図19)

の構造の素子270を生成できる。

[0085]

また、図19に示す上記素子の層77の上に、 V,O、: CuPcの層79を形成してITO/αNPD/Alq/Alq:Liq(1:1)、50Å/Al、15Å/V,O、: CuPc/CuPc/V,O、: CuPc/陰極(Al, ITO, etc) (図20)の様な構造を有する素子271を生成できる。これらの素子270、271によって、本来のホール輸送層としての機能と高エネルギー粒子によるダメージ低減層としての機能を併せ持つことが出来る。

【実施例8】

[0086]

実施例8は、本発明の有機素子を有機太陽電池への適用例である。

有機太陽電池素子は有機 E L 素子と似た構造を有しており、特に二層型タイプは、(ホール輸送性分子/電子輸送性分子)の界面で、光によって電荷発生することが知られている

例えば、

- 1) Appl. Phys. Lett., 48, 183 (1986)
- 2) Chemistry Letters, pp. 327-330 (1990)
- 3) Appl. Phys. Lett., 76, 2650 (2000)
- 4) Appl. Phys. Lett., 79, 126 (2001)
- 5) Appl. Phys. Lett., 80, 1667 (2002)

に記載されている、典型的な構造が知られている。

特に、上記の、2)や5)の文献では、従来の有機太陽電池の両電極に挟まれた部分(電荷発生ユニット)が複数個、直列に接続された構造が記載されており、例えば、5)の文献中では、

う

ITO/CuPc/PTCBI/Ag/CuPc/PTCBI/Ag

という、極薄(5 Å)のAg(銀)を使用して、電荷発生ユニット(CuPc/PTCB I)を2個直列に連結する構造がしめされている。

この極薄のAgの代わりに、本発明の「ホール電流 - 電子電流変換層」を使用することが 出来る。つまり、例えば

ITO/CuPc/PTCBI/PTCBI:Rb(DPM):Alの共蒸着層/V,O,:CuPcの共蒸着層/CuPc/PTCBI/Ag

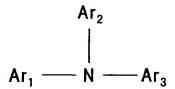
という構造によって、透明性が高く、かつ純粋な有機膜と比べても低抵抗化した膜であって、かつ、 2 個の電荷発生ユニットを、あたかも直列に接続できて、開放端電圧を略 2 倍とすることが出来る。上記の「PTCBI: Rb (DPM): Alの共蒸着層/V,O;:

CuPcの共蒸着層」が本発明の「ホール電流ー電子電流変換層」として作用する。

そのほか、ITO/((アリールアミン化合物等の)電子供与性(ホール輸送性)有機物):(V,O,や、4F-TCNQ等)/CuPc/PTCBI/((電子受容性(輸送性)有機物:低仕事関数金属のイオン含有化合物:熱還元性金属)の反応生成層)/((アリールアミン化合物等の)電子供与性(ホール輸送性)有機物):(V,O,や、4F-TCNQ等)の共蒸着膜/CuPc/PTCBI/((電子受容性(輸送性)有機物:低仕事関数金属のイオン含有化合物:熱還元性金属)の反応生成層)/金属の様に、従来から知られている、「電荷発生ユニット」の構成をそのまま使用して、該「電荷発生ユニット」を複数個、直列に接続できる。ここで、アミールアミンは、

[0087]

【化1】



で示される。

「電荷発生ユニット」の構成自体は、本発明の要素ではなく、既知のものや、新規に発見された好適な構成であれば、適宜用いることが出来る。なお、例えば、特開2003-2 64085号公報には、本発明と類似の構造で、上記文献1)に記載されている「電荷発生ユニット」の構成を用いて、

ITO/CuPc/PV/CuPc:PVの共蒸着膜/CuPc/PV/Auという構造が、開示されており、このような構造でも、あたかも、開放端電圧を2倍にすることが可能であるかのように記載されているが、本発明者の検討では、2倍はおろか、「電荷発生ユニット」が1個の素子よりも発生電圧が低下することが明らかになった。これは、同一の物質の組み合わせを使用しても、積層膜構造(CuPc/PV)と混合膜構造(CuPc:PVの共蒸着膜)の相違の様な、態様の相違によって、「光電荷の発生機能」や「(電荷移動錯体の形成による)導電性の発現」という互いに別事象の機能が起こりうる、という「間違った期待」から記載されている。しかし、実際には、本発明の「ホール電流−電子電流変換層」のような機能がなければ、期待される機能を得ることは出来ない。

【実施例9】

[0088]

実 施 例 9 は 、 本 発 明 の 有 機 素 子 を 有 機 E L ト ラ ン ジ ス タ へ 適 用 し た 例 で あ る 。

SIT (Static Induction Transistor) と呼ばれている、縦型FET (Field Effect Transistor) 構造を有する有機ELトランジスタが知られている。(第47回応用物理学関係連合講演会 講演予稿集30a-H-2, p. 1297、第63回応用物理学関係連合講演会 講演予稿集29p-2H-15, p. 1161)

このような有機 E L トランジスタの例として、図 2 1 に示すような素子 3 2 0 があり、基板 9 0 上に、順に、透明電極(ソース) 9 1 、ホール注入層 9 2 、ホール輸送層 9 3 、発光層 9 4 、陰極(ドレイン) 9 5 を形成してなる有機 E L 素子のホール輸送層 9 3 部分にスリット状のゲート電極(G) 9 6 が埋め込まれた形状を有しており、ゲート電極に印加される可変電圧値によって、発光閾値電圧や、発光強度を制御できる。しかし、(図 2 1 に示される通り)この構造によると、光の進行が妨げられたり、該ゲート電極のスリット間隔を自由に最適化することが難しくなる。

また、例えば、陽極91に接する層として、電子輸送層121を配置することが出来る(図23)。このとき、陽極91と電子輸送層121との間には、電子輸送部122を生成することができ、電子輸送層121とホール輸送層93との間に本発明のホール電流一電子電流変換層120を形成するホール輸送部99と電子輸送部100を生成することができる。また、透明陰極95と発光層94との間には電子注入層123を生成してある。このような構成の有機ELトランジスタ291においては、該電子輸送層121にスリット状ゲート電極96を埋め込んで、従来の有機EL素子部分の構造を変えることなく、トランジスタ特性を付与出来る。もちろん、陰極に接する層として、ホール輸送層を配置して、かつ、陽極に接する層として、電子輸送層を配置して、該ホール輸送層と該電子輸送層の両方にゲート電極を埋め込んで、従来、実現不可能であった特性を付与する構造も作成可能である。

[0089]

本発明について上記実施形態を参照しつつ説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、改良の目的または本発明の思想の範囲内において改良または変更が可能である。

【図面の簡単な説明】

[0090]

- 【図1】本発明の実施例1に係る有機EL素子の構造を示す図である。
- 【図2】本発明の実施例1に係る有機EL素子の動作概念を示す図である。
- 【図3】実施例1~3、比較例1及び参考例1に係る素子の電圧(V) 電流密度(m A / c m²) - 輝度(c d / m²) 特性を示す図である。
- 【図4】比較例1に係る有機EL素子の構造を示す図である。
- 【図 5 】 本 発 明 の 実 施 例 2 に 係 る 有 機 E L 素 子 の 構 造 を 示 す 図 で あ る。
- 【図6】本発明の実施例3に係る有機EL素子の構造を示す図である。
- 【 図 7 】 参 考 例 1 に 係 る 有 機 E L 素 子 の 構 造 を 示 す 図 で あ る 。
- 【図8】本発明の実施例1の構造を基準にして、アルミニウムの層の膜厚X(Å)を変化させたときの電圧(V)-電流密度(mA/cm²)-輝度(cd/m²)特性を示す図である。
- 【図9】本発明の実施例1の構造を基準にして、アルミニウムの層の膜厚X(Å)を変化させたときの電流密度(mA/cm²)-電流効率(cd/A)特性を示す図である。
- 【図10】本発明の実施例5に係る有機Eし素子の構造を示す図である。
- 【図11】本発明の実施例5に対する比較用素子に係る有機EL素子の構造を示す図である。
- 【 図 1 2 】 本 発 明 の 実 施 例 5 に 対 す る 比 較 用 索 子 に 係 る 有 機 E L 素 子 の 構 造 を 示 す 図 で あ

る。

- 【図13】吸光度測定用素子の構造を示す図である。
- 【図14】吸光度測定用素子に対する比較用素子の構造を示す図である。
- 【図 1 5 】本発明の実施例 5 に係る素子及び比較用素子の電場 (V / c m) -電流密度 (A / c m ') 特性を示す図である。
- 【図 1 6 】 吸光度測定用素子と比較用素子の波長 (n m) 透過率 (%) 特性を示す図である。
- 【図17】吸光度測定用素子と比較用素子の波長(nm)-吸光度特性を示す図である。
- 【図18】本発明の実施例6に係る素子の構造を示す図である。
- 【図19】本発明の実施例7に係る素子の構造を示す図である。
- 【図20】本発明の実施例7に係る素子の構造を示す図である。
- 【図21】従来のFET構造を有する有機EL素子の構造を示す図である。
- 【図 2 2 】 本発明の実施例 9 に係るFET構造を有する有機EL素子の構造を示す図である。
- 【図23】本発明の実施例9に係るFET構造を有する有機EL素子の構造を示す図である。
- 【図24】従来の有機EL素子構造を電荷発生層を介して2段(n=1)、5段(n=4)、10段(n=9)、と重ねた場合に、電力変換効率(1m/W)が各輝度ごとにどのように変化するかをシミュレートした図である。
- 【図25】駆動電圧をV,+V,+ Δ V とし、陰極や陽極からの注入障壁を無視した場合における発光ユニットを2個有するM P E 有機 E L 素子のバンド図である。
- 【図26】駆動電圧をV₁+V,とじ、陰極や陽極からの注入障壁を無視した場合における発光ユニットを2個有するMPE有機EL素子のバンド図である。

【符号の説明】

[0091]

- 10 基板
- 1 1 陽極
- 12 ホール輸送層
- 1 3 発光層
- 16 ホール輸送部
- 17 陰極
- 18 電子輸送部
- 19 ホール電流 電子電流変換

フロントページの続き

(51) Int. Cl.		FI			テーマコード (参考)
H 0 5 B	33/10	H 0 5 B	33/14	Α	
H 0 5 B	33/14	H 0 1 L	31/04	D	
		H01L	29/28		
		HOIL	29/80	V	
	·				
(72)発明者	横井 啓				
	神奈川県藤沢市桐原町3番地	株式会社アイメ	くス内		

神奈川県藤沢市桐原町3番地 株式会社アイメスト (72)発明者 仲田 壮志

神奈川県藤沢市桐原町3番地 株式会社アイメス内

(72)発明者 川村 恵史 神奈川県藤沢市桐原町3番地 株式会社アイメス内

(72)発明者 城戸 淳二 山形県米沢市林泉寺3-12-16

Fターム(参考) 3K007 AB01 AB05 AB18 DB03 FA01 5F051 AA11

5F102 FB01 GA14 GB06 GC08 GD04 GJ10 GL01 GR07